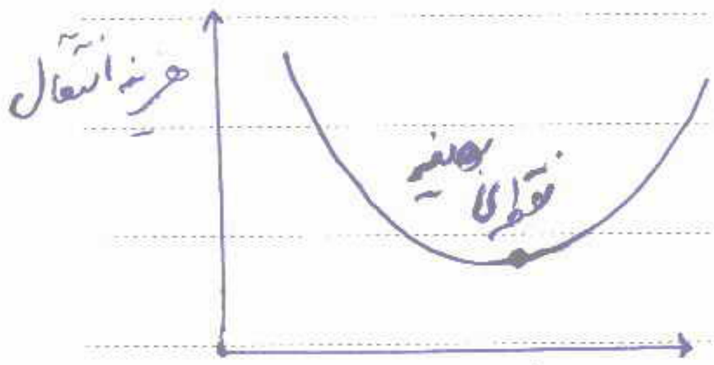
Subject: 1

Year. Month. Date. ( )

1. High Voltage Engineering. Fundamentals $\xrightarrow{by}$ Kuffel, Zaengl

۲. دانشگاه تهران - دکتر محسنی - مهندسی فشار قوی



باید تجهیزات را از نظر اینکه کل ولتاژهای بالا را دارند یا ندارند بررسی کرد.

۱. سقامت الکتریکی را با شدت میدانی که می‌تواند تحمل کند بررسی می‌کنند.

۱. ازدیاد الکترون اثر عایقی کمتر شدن تحمل خواهد شد چون روی میدان ها تأثیرات نامطلوبی می‌گذارد.

۱. باید بتوان ولتاژهای بالا تولید کرد.

۲. تست و اندازه‌گیری تجهیزات از نظر عایقی

۳. می سه میدان های الکتریکی

۴. انواع عایق‌ها { گازی / مایع / جامد

تلفات برق ایران حدود ۲۰ درصد است، در بوشهر حدود ۵۰ درصد است که البته شامل برق دزدی هم می‌شود.

قدرت نصب شده در ایران ۵۰ هزار مگاوات است و قابل استفاده‌ی آن ۴۰ هزار مگاوات است.

هر ۴۰۰ تراکنش دکل می‌زنند که هر کیلومتر حدود ۱۶۰ میلیون روی آید.

www.iran-ieee.com

Subject :

Year . Month . Date . ( )

ولتاژهای استاندارد

۱. ولتاژ معمولی با فرکانس قدرت (۵۰Hz یا ۶۰Hz)

۲. ولتاژ ضربه : ولتاژی است با دامنه ی بسیار بالا که در زمان کوتاه اعمال می شود.

۱. ولتاژ ناشی از رعد و برق ۲. ولتاژ ناشی از بازو بسته کردن کلید (که ممکن است تا ۲ برابر آید)

برای شبکه هایی که ولتاژ نامی آنها خیلی بالاست، ولتاژ ضربه ناشی از سوئیچینگ خطرناک است ولی در شبکه هایی که ولتاژ نامی آنها پایین تر است ولتاژ رعد و برق خطرناک تر است.

ولتاژهای سوئیچینگ چندین برابر ولتاژهای رعد و برق اند.

ولتاژ سوئیچینگ این خط ۴۰ kV

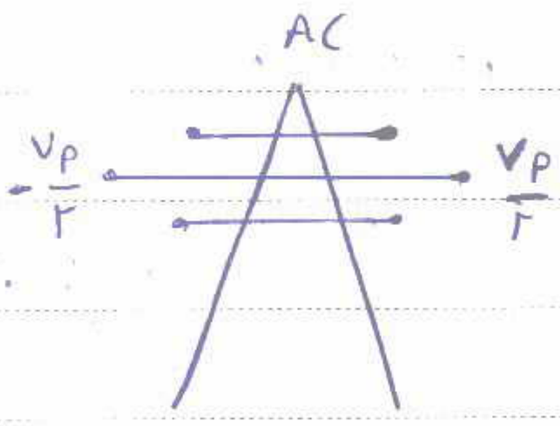
۲۰ kV → ۲۰۰ هزار ولت

ولتاژ رعد و برق

پس ولتاژ رعد و برق در شبکه هایی که تلفات ولتاژ نامی آنها پایین تر است، خطرناک تر است

ولتاژهای تست

۳. ولتاژ های AC :



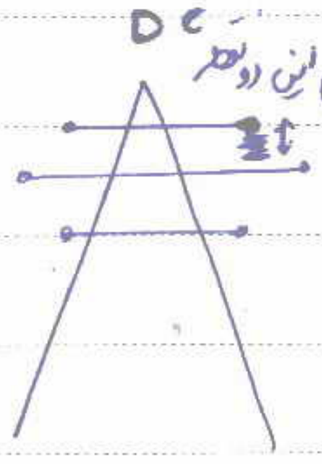
مدار

$2 \times \sqrt{3} V_L I_L \frac{1}{\cos\varphi}$

$2\sqrt{3} \times \sqrt{3} V_{Pn} I_P$

مقدار موثر است

سازنده قدرتی که می تواند با این خط AC اشتال دارد



$\sqrt{2} V_{Pn} = \frac{V_{DC}}{4} = V_{max}$ (rms)

$3 V_{DC} I_{DC}$

۳ تا فاز

اگر خط هایی که این ها با آن تست می شوند

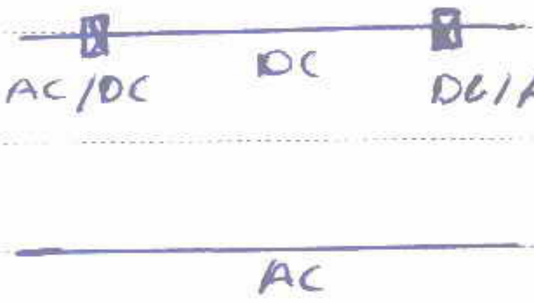
می توان $I_{DC} = \frac{1}{AC}$ گرفت

www.iran-ieee.com

Subject: ۲

Year. Month. Date. ( )

$$\frac{P_{DC}}{P_{AC}} = \frac{۳\sqrt{۲}\,V_{Pn}\,I_{DC}}{۶\,V_{Pn}\,I_{AC}} = \sqrt{۲} = ۱,۴۴ \qquad P_{DC} = \sqrt{۲}\,P_{AC}$$



این AC/DC ها گران اند و وقتی خط انتقال DC بهره‌تر است

که خط طولانی باشد.

جاهایی که خط‌های DC استفاده می‌شوند:

۱- جاهایی که خط خیلی طولانی باشد.

۲- این که تلفات آن $\%۶$ و نصف آن $\%۵۰$ است.

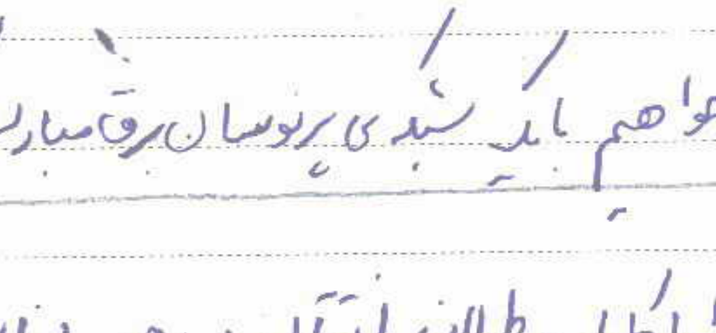
۳- جاهایی که می‌خواهیم باند شبکه‌ی برق‌رسان برق مبادله کنیم و این دو تا شبکه با فرکانس (ترنتو و سیدنی)

۴- جاهایی که برق را با کابل و طولانی انتقال می‌دهیم. (فرانسه و انگلستان از طریق کابل داخل دریا مبادله برق دارند)

چون در کابل‌ها خاصیت خازنی زیاد می‌شود و کابل‌های سوزد.

تولید ولتاژ DC: ولتاژی که تغییرات کمی داشته باشد و تقریباً ثابت باشد.

ولتاژ متوسط $\left(\bar{V} = \frac{۱}{T}\int_{۰}^{T} v(t)\,dt\right)$



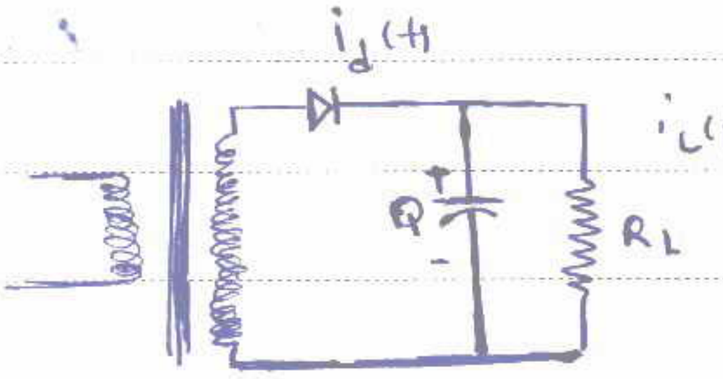
دامنه ولتاژ ریپل $\left(\delta V = \frac{۱}{۲}(V_{max} - V_{min})\right)$

ripple factor $\left(\frac{\delta V}{V} \leq ۵\%\right)$ ⟵ مثلاً در روش ۴ پالس، ۱۰۰ kV، ۱۰ kV - ۹۵ kV

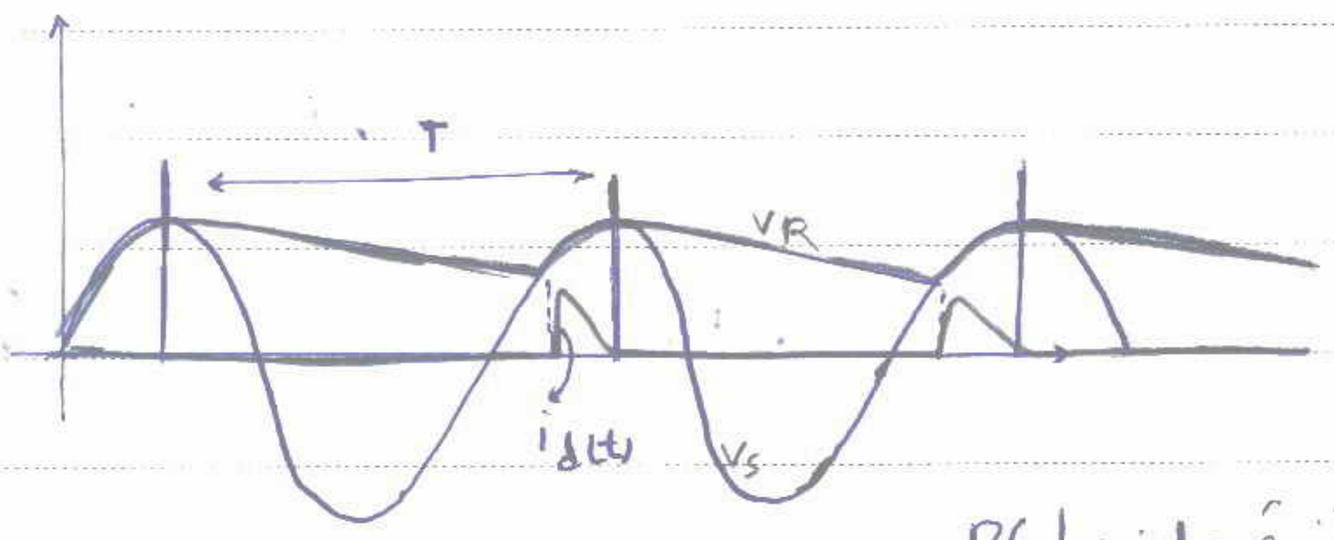
www.iran-ieee.com

روش های تولید ولتاژ DC :

۱- یکسو سازی نیم موج :



$i_d(t)$ خیلی کمتر از $i_L(t)$ است باید از یکسو سازی استفاده کرد که کمک این جریان را داشته باشد.

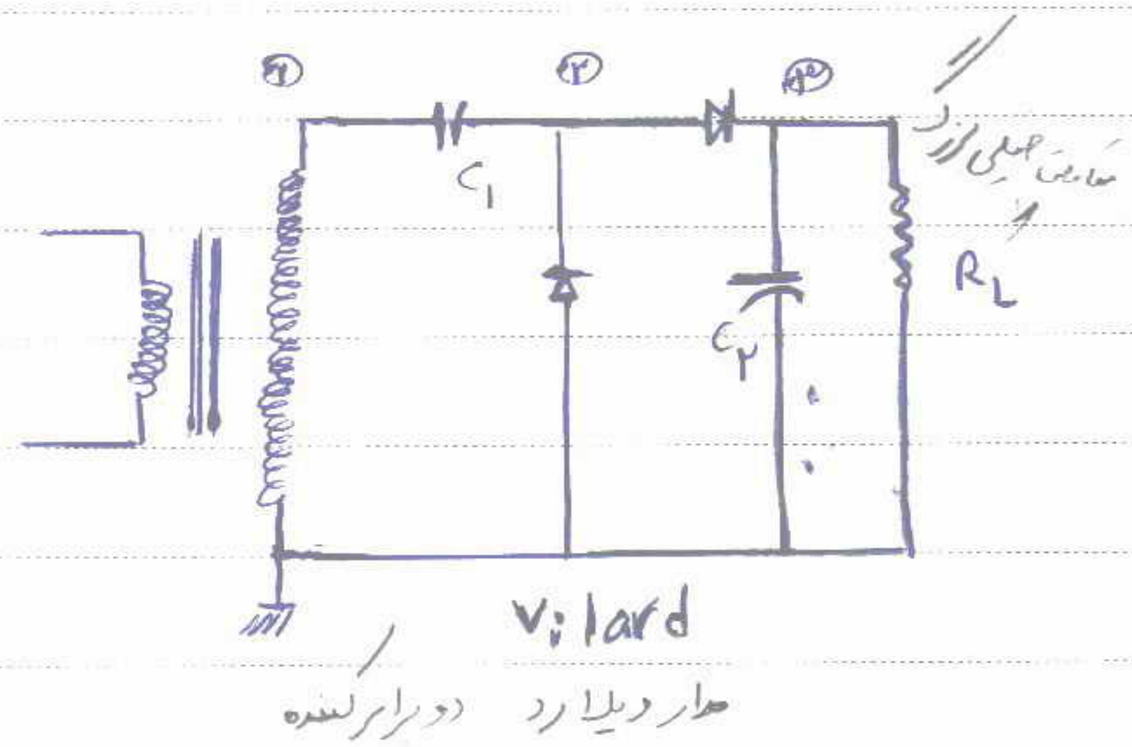


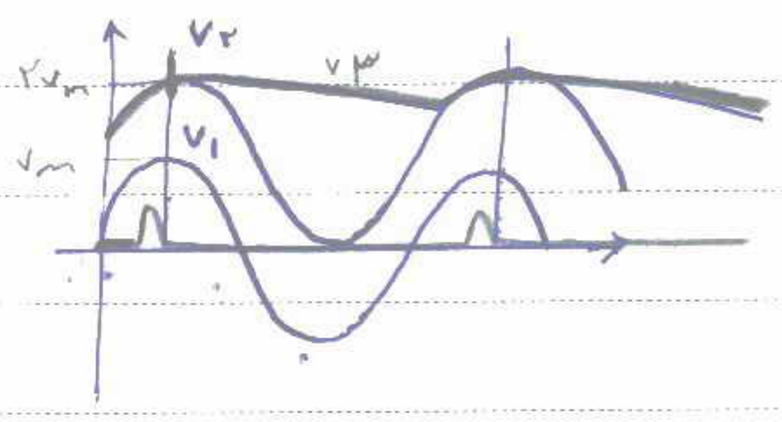
اگر بخواهیم ripple را کم کنیم خازن را بزرگ و تا حد امکان بزرگ انتخاب می کنیم چون خازن را همان 50^{HZ} در حالت گرید و ظرفیت این خازن تعیین کننده قیمت این مولد DC خواهد بود.

$$i = C\,dv/dt \qquad Q = 2\delta V C = IT$$

تغییرات ولتاژ با زمان ثابت

$$\left(\delta V = \frac{IT}{2C} = \frac{I}{2fC}\right)$$

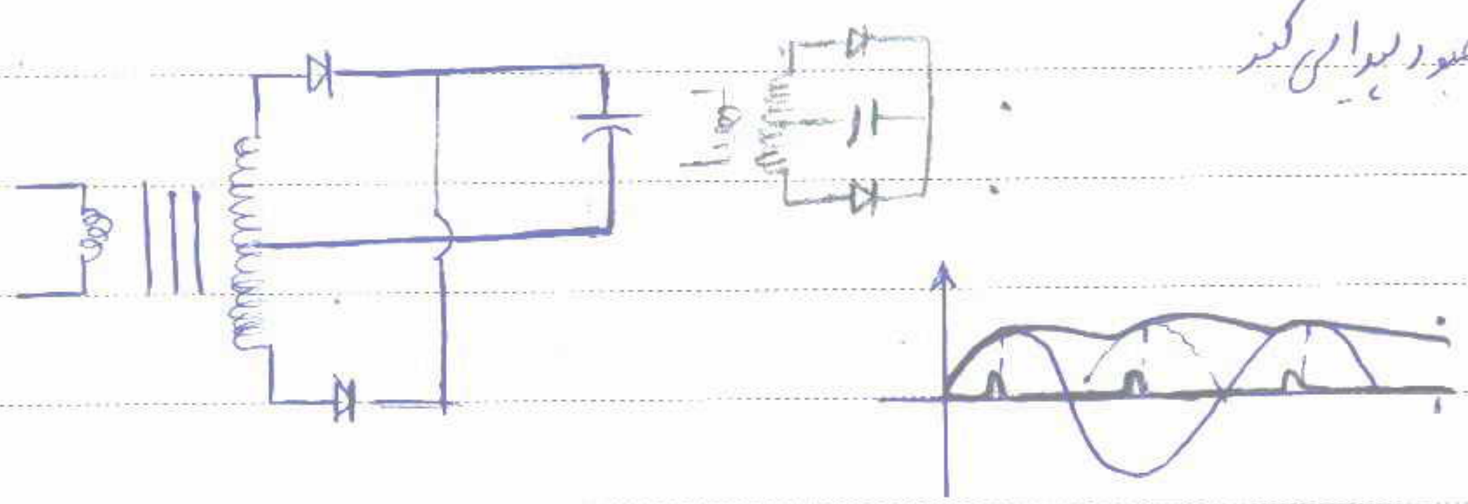




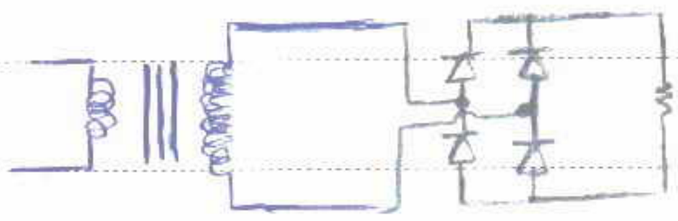
www.iran-ieee.com

Subject: ۳

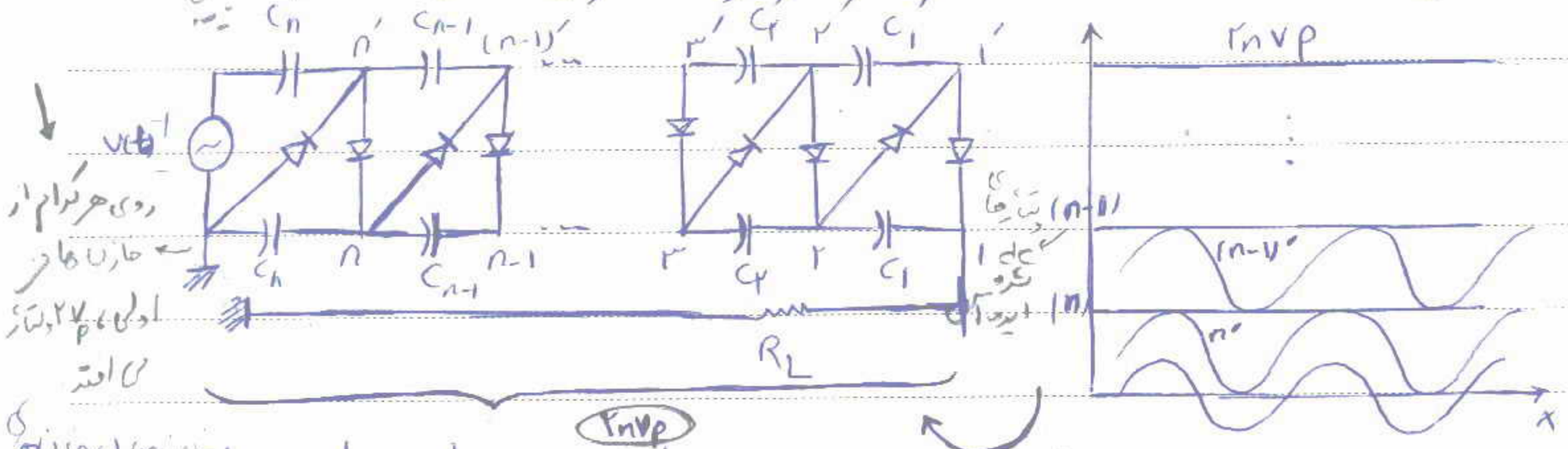
Year. Month. Date. ( )



راین مدار مقدار ripple ۱۶V را بهبود میدهد



۲- مدارهای ولتاژ چند طبقه:



- مولد ولتاژ گرانیاک -

- جریان تأمین محدود است (mA)

- حداقل ولتاژ خازن ها برای هر کسوسار $2V_m$ است.

- بهترین کارایی آن در طبقات پایین تر طرف خازن ها بیشتر است:

$$\delta V = \frac{I}{2f}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{2}{C_2} + \cdots + \frac{n}{C_n}\right)$$

۱. در این مدار با اضافه کردن هر طبقه ripple از آن کم می یابد مگر اینکه:

$$C_1 = C_2 = \cdots = C$$

$$\left(\delta V = \frac{I}{fC} \times \frac{n(n+1)}{4}\right)$$

۲. بین طبقه های مختلف هیچ عایقی از نظر فیزیکی وجود ندارد.

- پایین ترین طبقه بیشترین ولتاژ را دارد، زیرا هر طبقه بر طبقات بالایی تأثیر دارد.

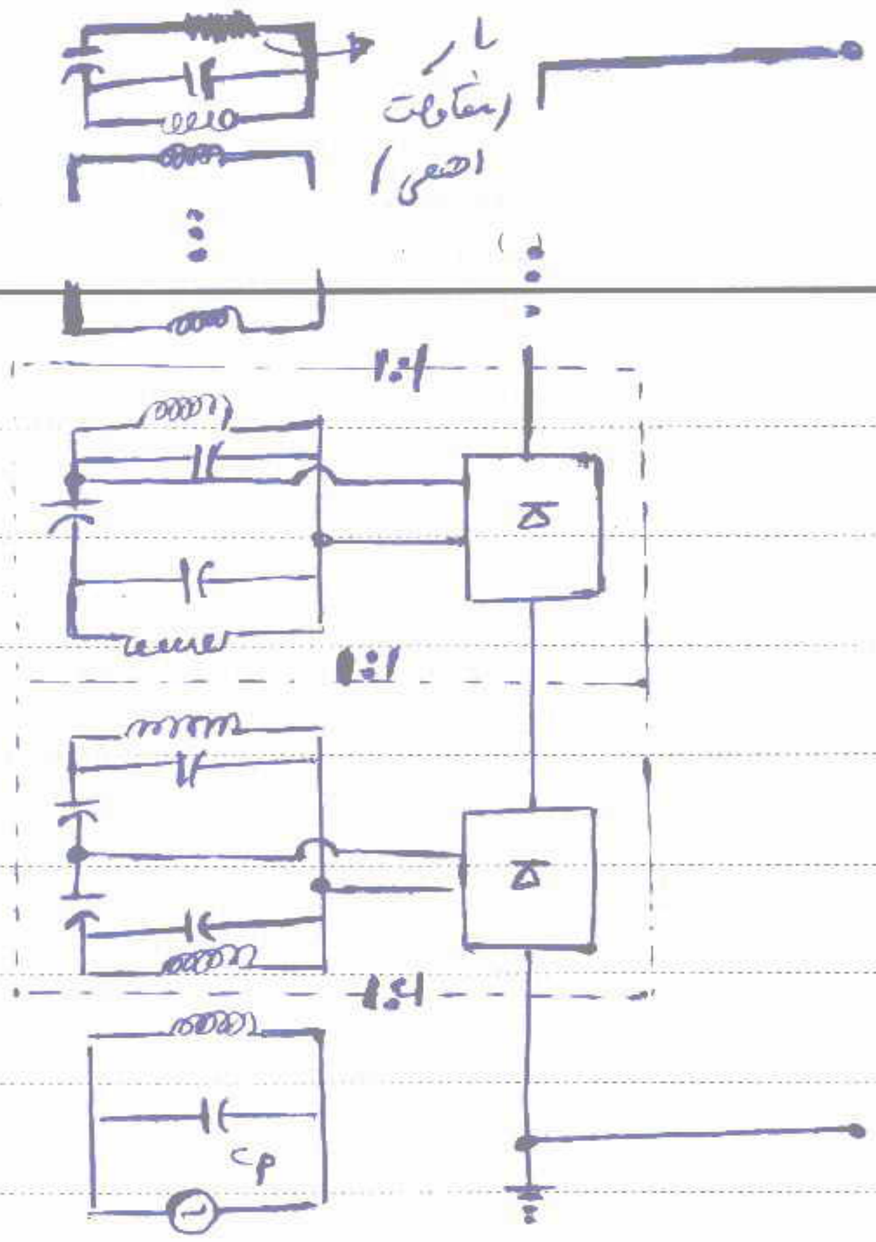
- هر طبقه از طبقه پایین تأمین می شود.

- مدارهای Deltatron و Engetron -

www.iran-ieee.com

Subject :

Year .



- خازن های سری ، اتوکنتاس را خنثی می کنند.

- ولتاژ خروجی ترانس ها باید مثل اشعه

شکل

هسته ایجاد می شود برای حل این کار هسته از آهن ورق نازک تشکیل شده آن ها با بالا رفتن هر طبقه افزایش می یابد

حوا استفاده کرده اما بدون هسته مثل مغناطیس نشدن

نیاز است که برای تأمین آن از خازن استفاده کردند.

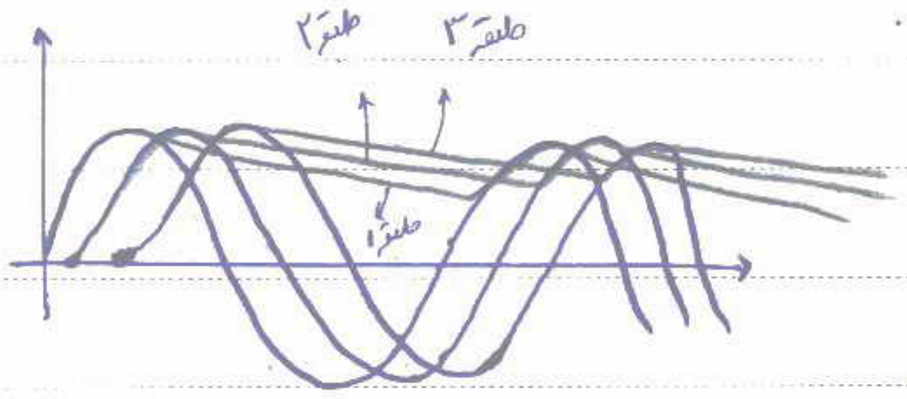
سوار بار با اختلاف

- در این مولد نانوی هر طبقه با دیگر طبقه بعد است

- اگر با اینتهای خط کم باشد و نتاژ بالای رو رول اگر بار اینتهای خط زیاد باشد و نتاژ پایین می آید.

- اگر بار $\sqrt{3}$ = z باشد افزایش ی ولتاژ در تمام طول خط یکسان خواهد بود و مقاومتی زاویه تغیری کند

- این مولد در حقیقت مدخط انتقال است که ولتاژ آن را z انتقال



کرد. اندازه تا ولتاژ در همه ی آن یکی باشد و فقط از اور ولتاژ

تغیر کند و این تأخیر شکل موج ولتاژ هر طبقه را با هم این قضیه

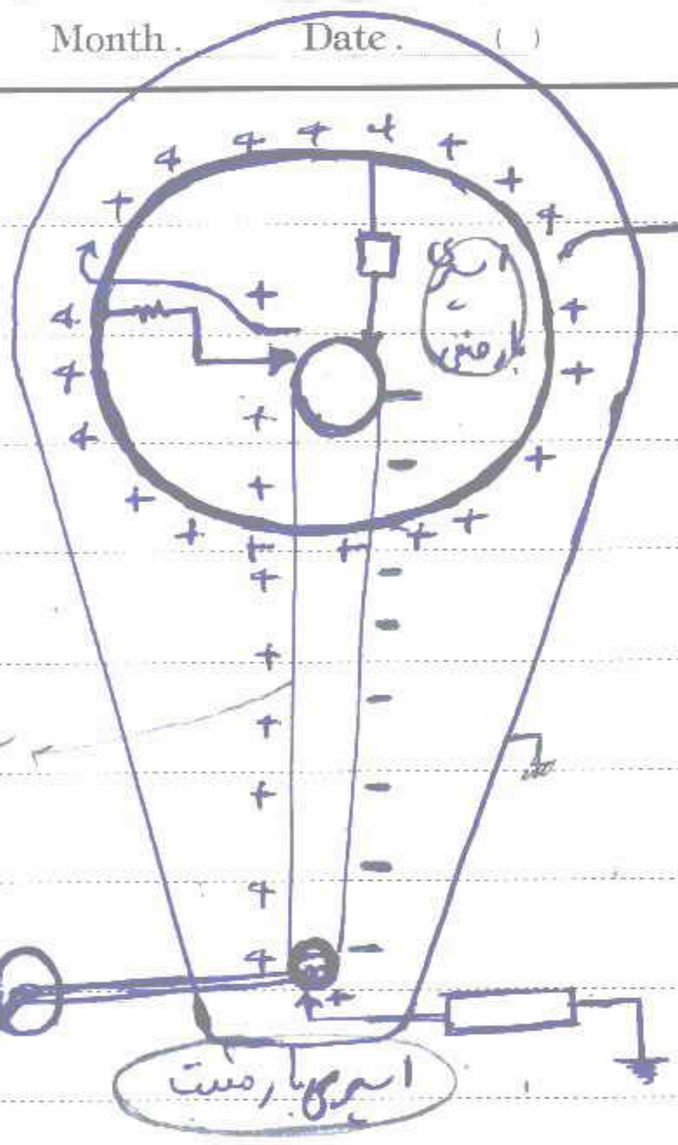
است که ولتی این ۳ شکل موج در خروجی جمع می شود ripple کاهش می یابد.

PqPCO

www.iran-ieee.com

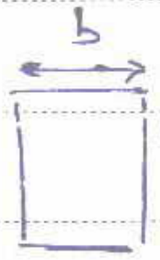
Subject: ۴

Year. Month. Date. ( )



۱- مولد وان دوگراف مز-
یا مولد دینامیک الکترواستاتیک

این مولدها ولتاژ را می‌تواند تا چندین میلیون ولت بالا ببرد



(A) با سرعت ثابت
(m) با پهنای ثابت
(C/m²) و چگالی باری که روی نوار می‌گذارد

مقدار بار عبوری ($I = \sigma b v$)

بالاترین جریانی که می‌توان با این مولد ساخت:

$\sigma = 2 \times 10^{-4}\ C/m^2$ $\quad v = 20\ m/s$ $\quad b = 1\ m$

علت این ولتاژ خطرناک نیست چون بار کمی روی آن جمع می‌شود.

$I = 4 \times 10^{-4}\ A = 400\ \mu A$

جریان بسیار کمی خواهد داشت. این مولد ولتاژ اش زیاد تنظیم شده نیست.

جریان بین $10^{-4}\ A$ تا $10^{-3}\ A$

ابزارهای ولتاژ ... برای تغییر ولتاژ DC

تولید ولتاژ AC: امکان ساخت ولتاژ سینوسی کامل وجود ندارد یعنی حتی ولتاژ ژنراتورها هم تقریباً سینوسی است.

ولتاژ مؤثر نسبت $\frac{V_p}{V_{rms}} = \sqrt{2}$ یا $\frac{V_p}{V_{rms}} \simeq \sqrt{2}$ را نیز سینوسی فرض می‌کنیم.

$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$ (موج)

$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt}$

$\frac{V_p}{V_{rms}} \simeq \sqrt{2} \rightarrow \frac{V_p}{V_{rms}} = \sqrt{2} \pm 5\%\sqrt{2}$

به عنوان سینوسی کامل قبول است

در تست تجهیزات هسته‌دار برای اینکه از شر پرتوهای نرون از ژنراتورهای بالاتر از نامی استفاده می‌کنیم به خصوص ژنراتورهای نامی

منبع ولتاژ تست باید علاوه بر ولتاژ، جریان را هم تأمین کند

تجهیز مورد تست

جریان و ولتاژی که منبع ولتاژ تست باید تأمین کند.

$\begin{cases} I = J\omega C V_t \\ P = J\omega C V_t^2 \end{cases}$ ← J عدد موجی

PAPCO

iran-ieee.com

www.iran-ieee.com

Subject :

Year . Month . Date . ( )

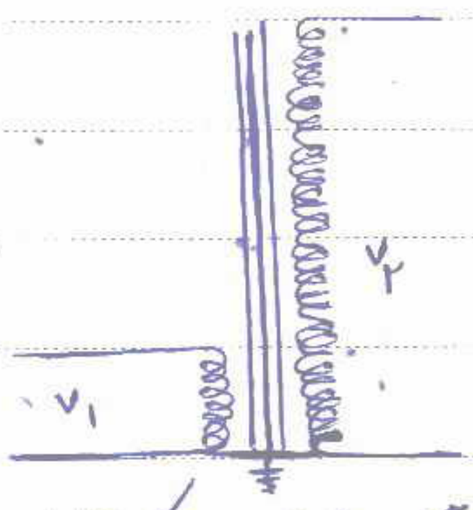
— اگر این جریان تامین نشود ستاندارت نخواهد بود ، کفاسیکر جریان بیشتر از جریان نامی است و دیگر خاصیت ترانس را ندارد

$P_n = K \omega C V_t^2$

ظرفیت خازنی تجهیزی که باید تست شود

ترانسفورماتور تست :

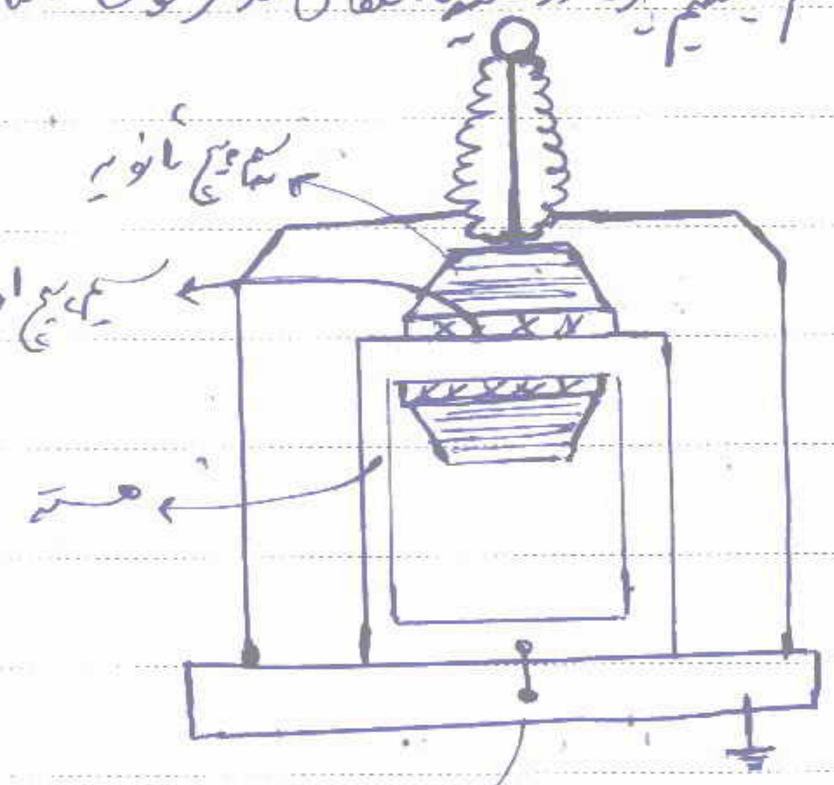
در ترانس های معمولی هدف انتقال قدرت است ،



در تست تلفات برای ما مهم است ولی در این ترانس ها اینکه سیم پیچ

کدام یک مهم است

با استفاده از ورنیر (ماشین الکترونیک دستگاهی) برای انتقال حداکثر توان ۵۰٪ تلفات



خواهیم داشت $Z_{eq} = Z_{in}$

$C = \varepsilon A / d$

$cte = 2\pi r h$

سیم پیچ ثانویه را نزدیک تر انتخاب می کنیم چون می خواهیم ظرفیت خازنی حاصل از سیم پیچ

ثانویه بالا باشد بعدی ثابت باشد که در صورت ثابت بودن خازن می تواند

میدان یکنواخت باشد و با این کار عایق کاری کاهش می یابد در صورتی که

اگر میدان یکنواخت نباشد باید عایق کاری انجام شده برای بیشترین میدان باشد .

مقایسه ۱: این ترانس از آنجا که ترانس فلزی است برای مدتی با بیرون انتقال گرما دارد ولی در ترانس بعدی چون بدنه از جنس عایق است معادل گاز بیشتر است

مقایسه ۲: این ترانس ارتفاعش کم است در حالی که ترانس بعدی ارتفاع زیادی خواهد داشت

مقایسه ۳: در این ترانس برای سوی کردن شدن باید هر ترانس را روی پله ای بالاتر گذاشت که آن پله از جنس عایق خواهد بود

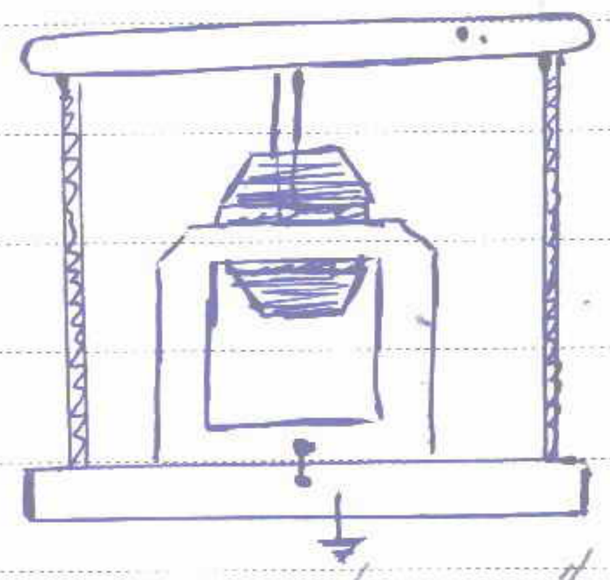
Papco

www.iran-ieee.com

Subject: ۵

Year. Month. Date. ( )

دلی ترانس بدی را برای سری کردن روی هم دیگری توان قرار دارد.



ترانسفورماتورهای کاسکاد یا چندطبقه:

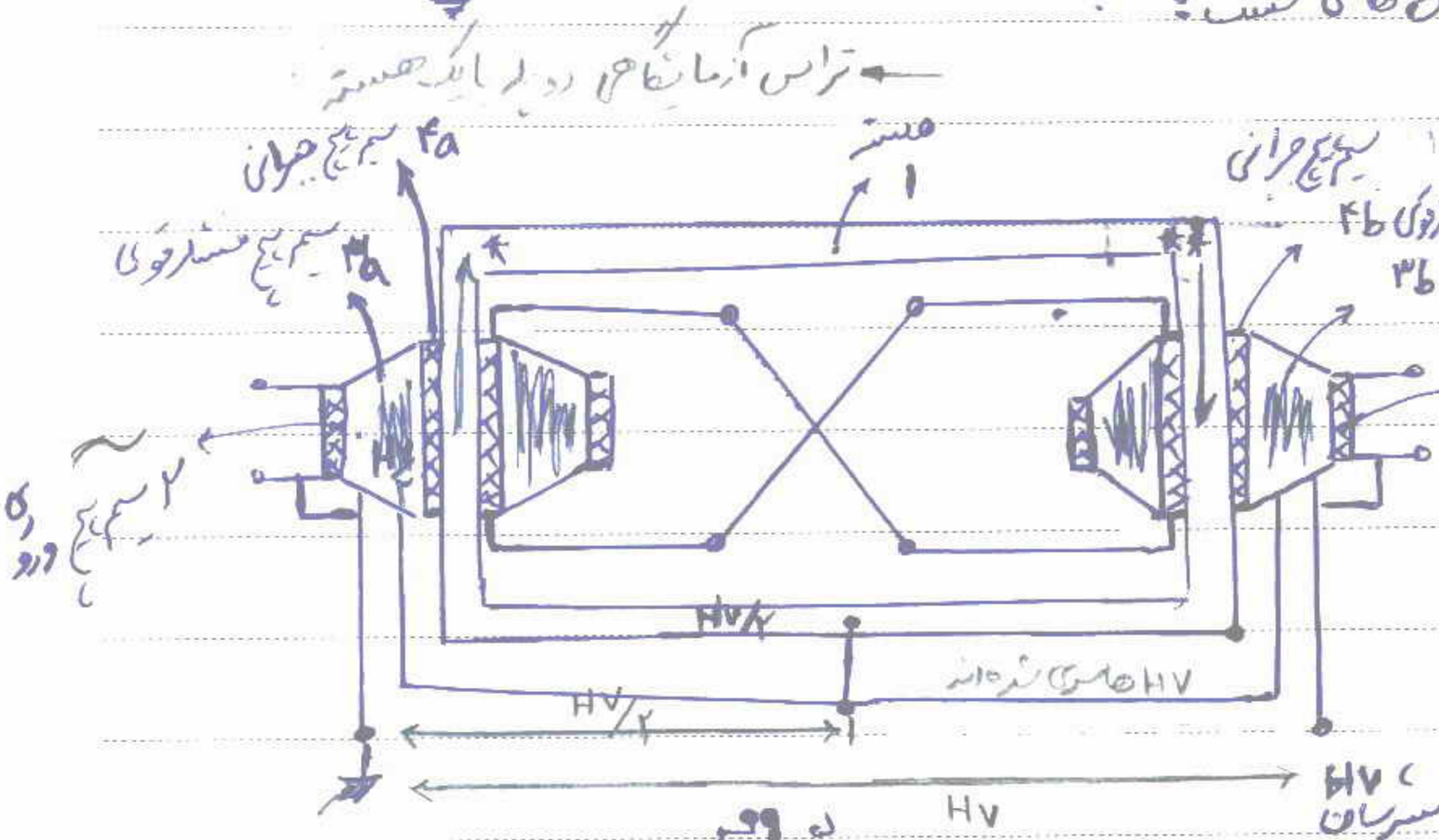
- یکی از روش های سری کردن ترانس های تست:

- تحمل هسته $\frac{HV}{2}$ است.

- هر وقتی که ۲ دارد ۵ هم دارد با

این تفاوت که فرض ها متفاوت

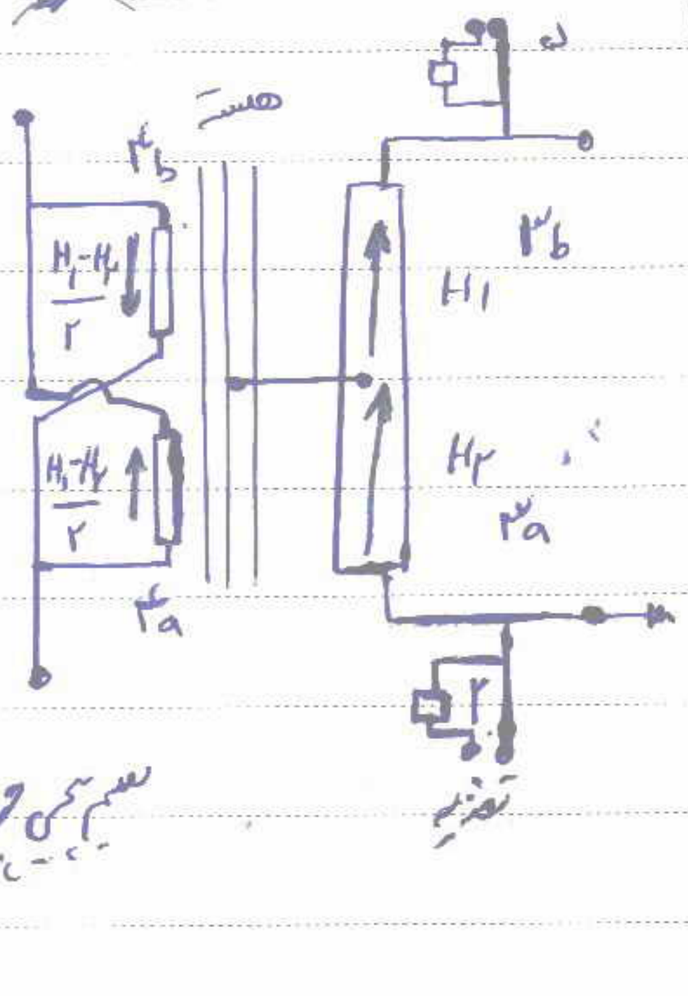
است (HV و زمین)



- شارهای * و ** و *** باید برابر باشند تا شار فعال مسیرشان HV در هسته بسته شود و تغییر باعث گرم شدن و اعوجاج خواهد شد

که با سیم پیچی نمی توان این شارها را برابر کرد بلکه از سیم پیچی جبرانی برای این کار استفاده می کنند بطوری که

$$H_1 - \frac{H_1 - H_2}{2} = \frac{H_1 - H_2}{2} + H_2 = \frac{H_1 + H_2}{2}$$



- سیم پیچی فشارقوی را روتکر ساخته اند بنا طرصرفجویی در خاصیت عایقی و ولتاژی را با هسته هم پتانسیل کرده اند

و با این کار امکان ندارد

- سیم پیچی فشارضعیف را می هسته ای بنوند چون عایق بندی کمتر نیاز دارد ولی در اینجا سیم پیچ فشارقوی را نزدیک به هسته بسته اند اما ولتاژش را با هسته هم پتانسیل کرده اند.

- می توان رو یا هندرستگاه از این ترانس ها را بصورت کاسکاد بهم وصل نمود و برای ترانس های فشارقوی استفاده کرد و ترانس خیلی برای کمتر از ۱۰۰ KV اقتصادی نمی شود

- وقتی سیم پیچی ثانویه اتصال یک سلف بسته ای ندارند و سیم پیچی جبرانی شبیه همین سلف بسته است.

PARCO
www.iran-ieee.com

-جریان این ترانس ها کم است و بار آنها معمولاً خازنی می باشد چون این ترانس های آزمایش عایق دستگاه ها کاربرد دارند که این عایق ها مشکل خازنی می دهند: که برای جبران این بار خازنی در هر پله یک راکتور قرار می دهند، هرچه با این راکتور می توان ضلع های بالای جریان نیز تنظیم کرد. -بهترین جبران سازی فنقری بیشتر از مقدار بار خازنی هم باشد تا مجموعه ی بار سلفی (راکتور) شود چون ترانس ها برای بارهای خازنی امنیت ولتاژ حق را دارم یعنی ولتاژ خروجی بیش از ولتاژ ورودی ضریب در سمت ثانویه است.

برای Cascades / کاسکاد

ترانس آزمایشگاهی سه پله

یک توان می تواند پس را اندازه خود بیشتر است

coupling / سیم پیچ کوپلینگ

x کوان ۲ برای موتور

داریس ۲ تا برای جبران نمایند پس

۲P توان

سیم پیچ تحریک / سیم پیچ تغذیه / سیم پیچ ثانویه

با این تفاوت که تغذیه ثانویه کار آن HV است

1:1

Xe

2P

P hv

جریان سلولی دارنده

سیم پیچ اولیه

3P

تغذیه

سیم پیچ ثانویه

3hv

ترانس طبقه پایینی بیشترین جریان را خواهد داشت چون اصل توان را این طبقه تأمین می کند و ممکن است هسته آن به اشباع برود.

- سیم پیچ coupling از نظر کاری دو آخرین لایه سیم پیچ ثانویه ترانس ولتاژ دار و یک سر آن به سر خروجی سیم پیچ ثانویه وصل است - هسته و بدنه هر پله از این سیم پیچ فشار قوی هر پله وصل است

- همچنین یک سر سیم پیچ اولیه بوبین و هسته ی همان پله وصل است - پله های دوم و سوم و ... (دارای بارها) عایق قرار دارند -

اولیه — کوپلینگ — فشار قوی

n تعداد طبقات

$$X_{res} = \sum_{v=1}^{n} \left[X_{hv} + (n-v)^2 X_{ev} + (n+1-v)^2 X_{pv} \right]$$

$1^2+1^2+1^2$ 1^2+2^2 $1^2+2^2+3^2$

$$X_{res} = 3X_h + 5X_e + 14X_p \quad \text{برای 3 طبقه}$$

برای حل این مشکل باید طبقات پایین تر X آن کوچکتر باشد تا جریان بیشتر طبقات پایین تر مشکل ساز نباشد ولی اشکال این ایده این است که خرید چند نوع اتصالی نیست

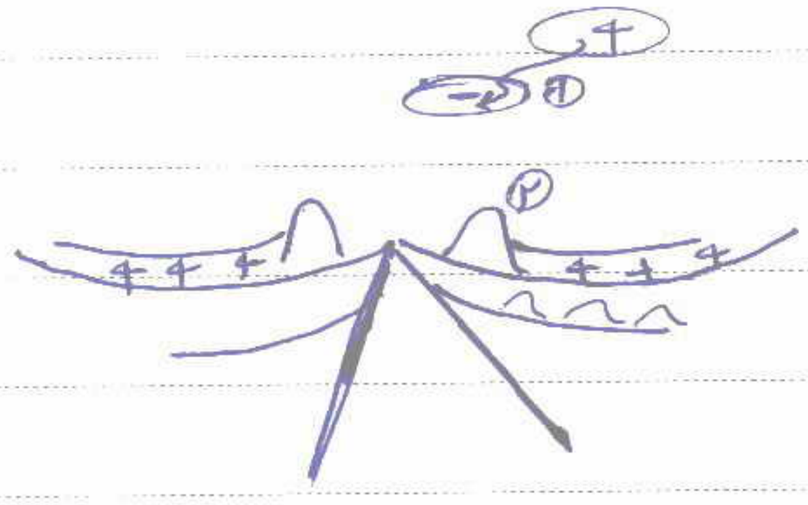
www.iran-ieee.com

Subject: ۶
Year. Month. Date. ( )

تولید ولتاژ ضربه:

۱. ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ (کلیدزنی) کوتاه مدت شبکه بیشتری دارد

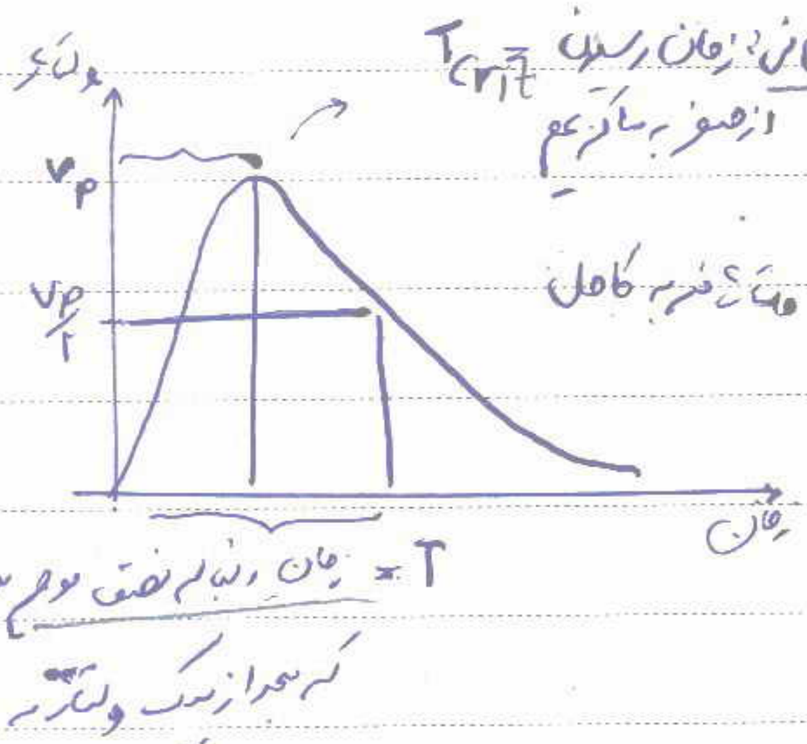
۲. ولتاژ ناشی از رعد برق



هیچ ولتاژ ضربه شبیه هم نیست و استاندارد آن به صورت زیر است:

- برای تست عایقی در مقابل موج رعد و برق $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{250}$ $\frac{\text{ثانیه}}{\text{ثانیه}}$

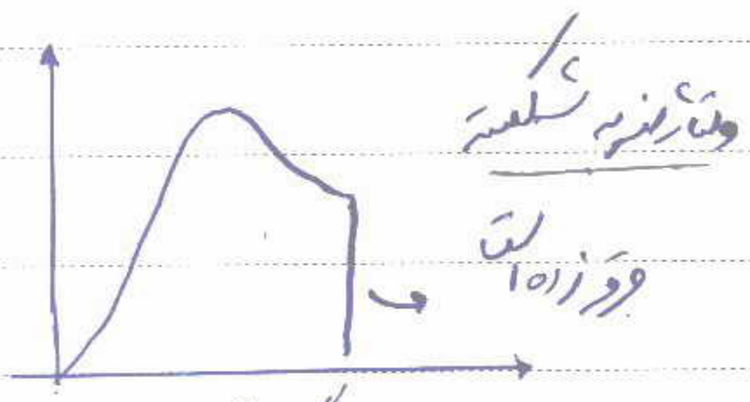
- برای تست کلیدزنی $\begin{cases} T_{C2} = 250\ \mu s \\ T_2 = 2500\ \mu s \end{cases}$



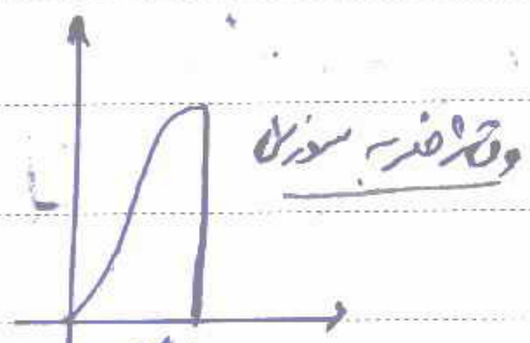
T_{C2} زمان رسیدن: زمان رسیدن از صفر به ماکزیمم

T_2 نیم زمان: زمان رسیدن به نصف ماکزیمم کامل

T = زمان رسیدن نصف موج یعنی زمانی که بعد از شکست ولتاژ به $\frac{V_P}{2}$ می رسد



ولتاژ ضربه شکسته: ولتاژ است و زمان نیمه



ولتاژ ضربه سوزنی: زمانی قبل یا ذروه ماکزیمم است

ولتاژ ضربه کامل: $\begin{cases} V_P \\ T_{C2} \\ T_2 \text{ نصف عمر زمان} \end{cases}$

ولتاژ ضربه شکسته: $\begin{cases} V_P \\ T_{C2} \\ T \text{ زمان از ایجاد تا زمان شکست} \end{cases}$

ولتاژ ضربه سوزنی: $\begin{cases} V_P \\ T \text{ زمان تا شکست} \end{cases}$

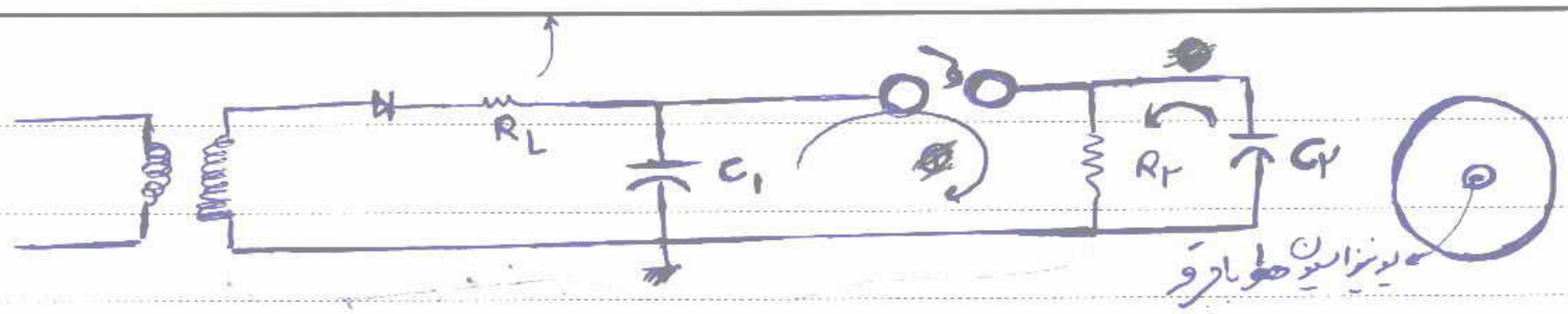
نتیجه: در تست کامل را جواب رها نمی دهد.

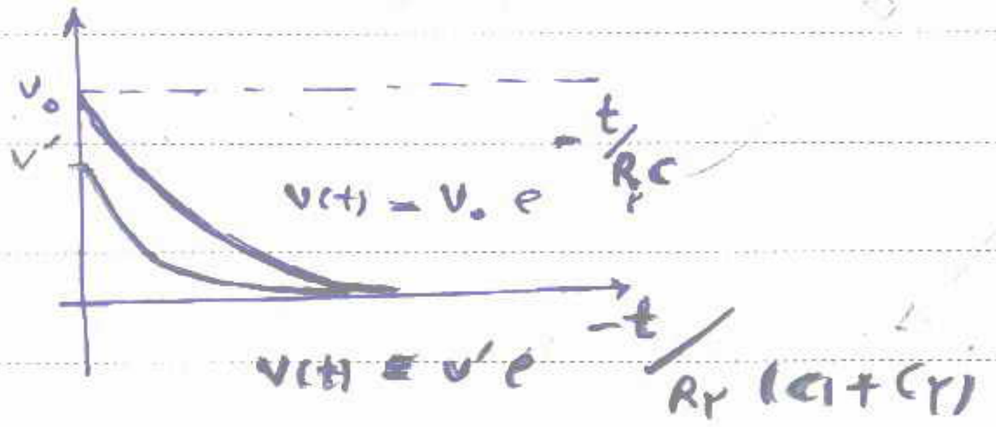
PAPCO

www.iran-ieee.com

Subject: مقاومت بار در مدار نقش محدود کردن جریان را دارد

Year. Month. Date. ( )





(با شلف پیوسته ضربه ایجاد می‌کند چون ولتاژ آن به $\frac{di}{dt}$ بستگی دارد که یعنی ولتاژ به سرعت و تغییرات جریان بستگی دارد که برای ما کنترل پذیر نیست)

$$Q = C_1 V_0 = (C_1 + C_2) V' \longrightarrow V' = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_0$$

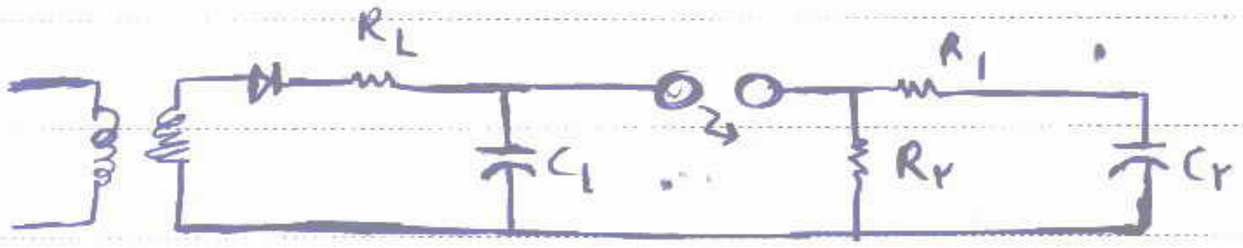
بایستگی بار

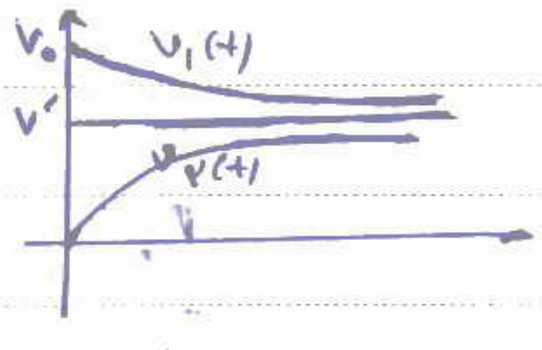
بار کل مقدار ثابتی است

مقدار انرژی ذخیره شده صرف حرارت و یونیزاسیون می‌شود

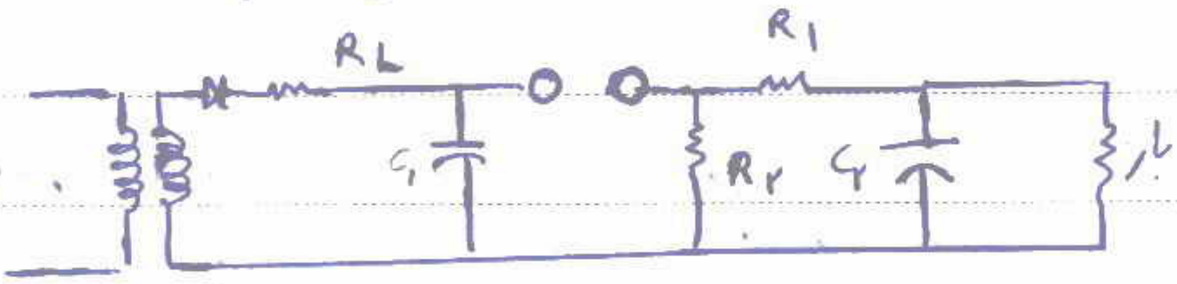
$\frac{1}{2} C_1 V_0^2 > \frac{1}{2}(C_1 + C_2) V'^2$

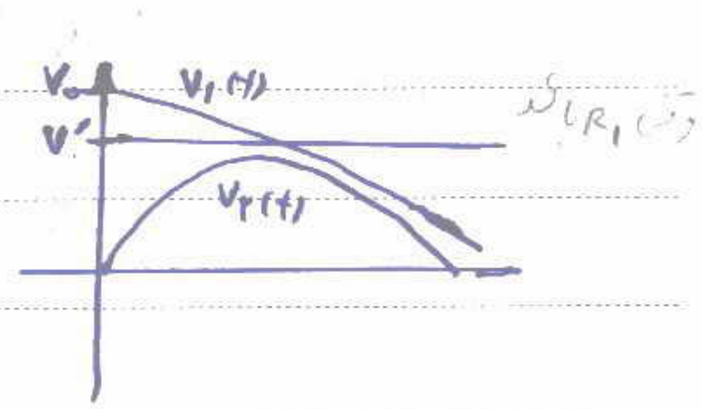
انرژی





وقتی R_1 زیاد





وقتی R_1 کم

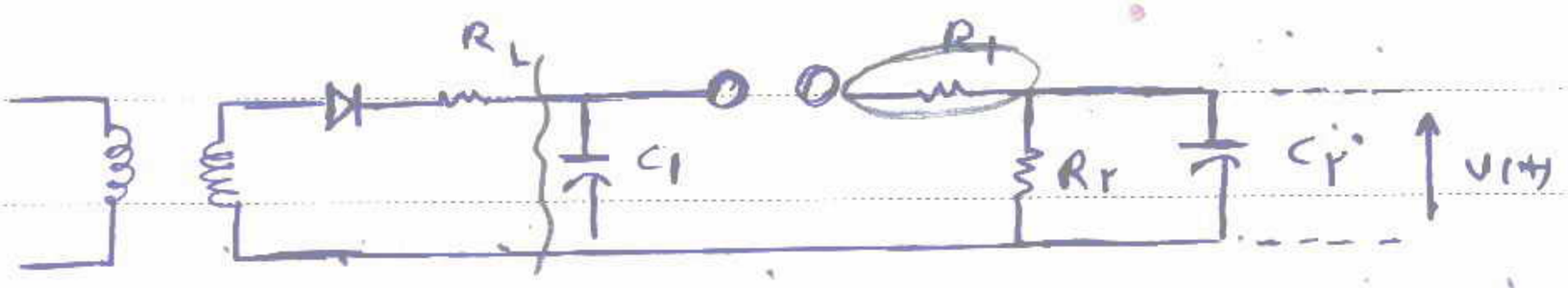
PaPCO

www.iran-ieee.com

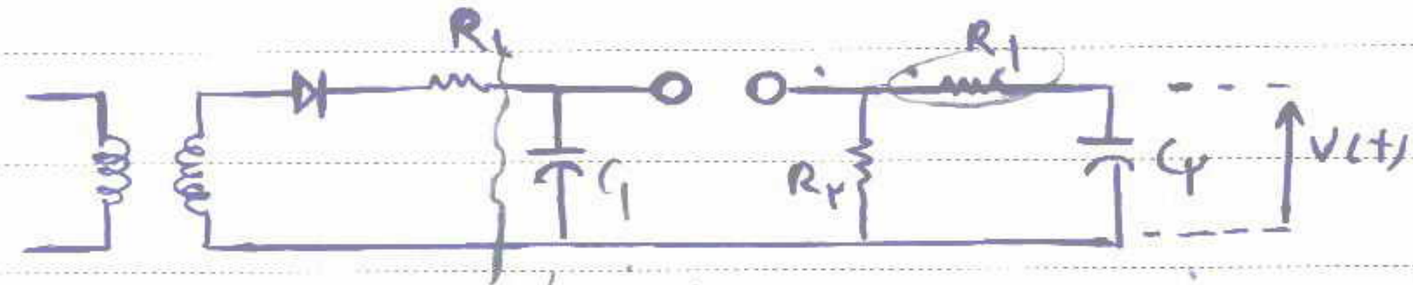
Subject: V

Year. Month. Date. ( )

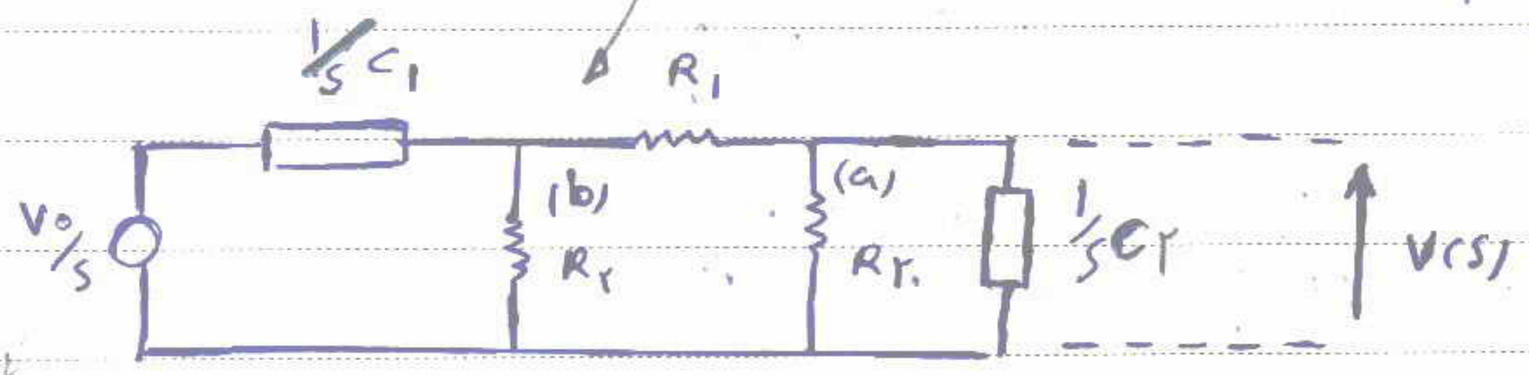
(a)



(b)



با لاپلاس



$$V(s) = \frac{V_0}{s}\,\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}\,,\quad Z_1 = \frac{1}{C_1 s} + R_1 \qquad Z_2 = \frac{R_2/C_2 s}{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}$$

$$V(s) = \frac{V_0}{K}\,\frac{1}{s^2 + As + B}$$

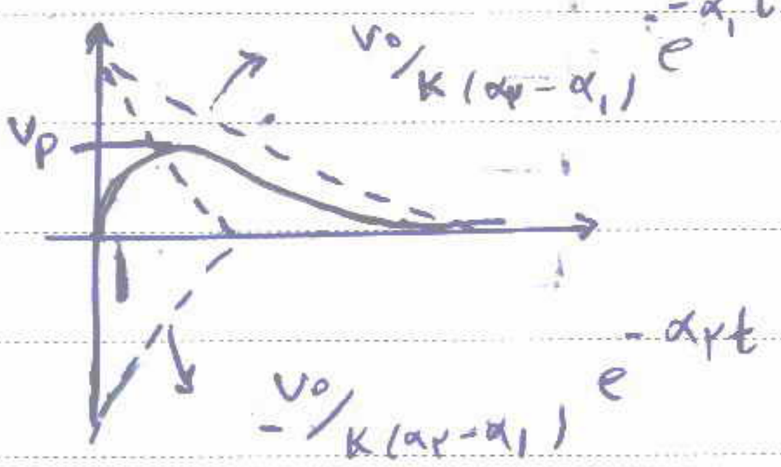
a) $$A = \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}$$

b) $$A = \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_1}$$

$$B = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \qquad K = R_1 C_2 \qquad \text{" , "}$$

$$s^2 + As + B = 0 \;\Rightarrow\; \alpha_1, \alpha_2 = \frac{A}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 - B}$$

$$v(t) = \frac{V_0}{K}\,\frac{1}{\alpha_2 - \alpha_1}\left(e^{-\alpha_1 t} - e^{-\alpha_2 t}\right)$$



$$q = \frac{V_p}{V_0}$$ (ضریب)

$$\frac{dv(t)}{dt} = 0$$

PAPCO

www.iran-ieee.com

Subject :

Year . Month . Date . ( )

$t_{max} = t_{cr} =$ مقدار مورد نظر طراحی

$$\rightarrow t_{max} = \frac{\ln(\alpha_2/\alpha_1)}{(\alpha_2 - \alpha_1)}$$

$$\eta = \frac{(\alpha_2/\alpha_1)^{-[\alpha_1/(\alpha_2-\alpha_1)]} - (\alpha_2/\alpha_1)^{-[\alpha_2/(\alpha_2-\alpha_1)]}}{K(\alpha_2-\alpha_1)}$$

A) $\eta_A \approx \frac{C_1}{C_1+C_2} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{1}{1+\frac{C_2}{C_1}} \times \frac{1}{1+\frac{R_1}{R_2}}$

B) $\eta_B \approx \frac{C_1}{C_1+C_2} = \frac{1}{1+\frac{C_2}{C_1}}$ $\quad \eta_B > \eta_A$

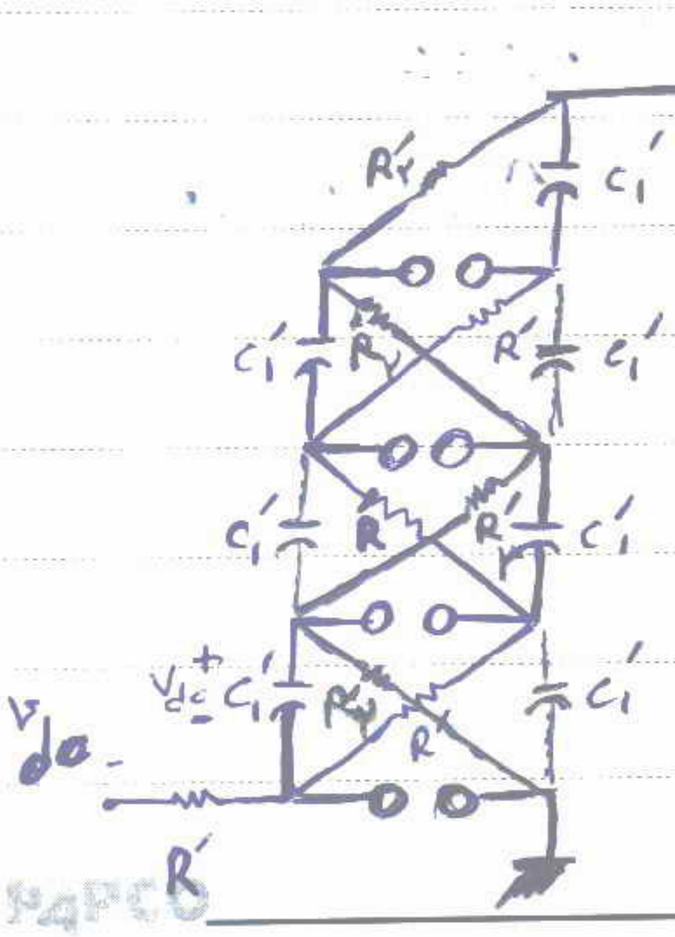
هر خازن شارژ می‌شود تا ولتاژ دو سر آن

$-V_{dc}$

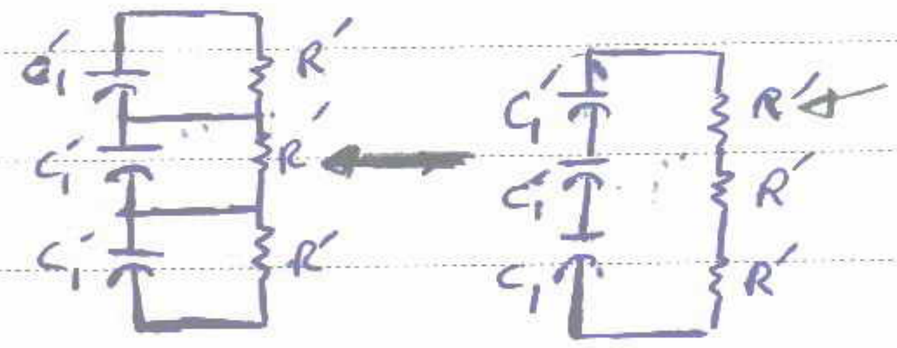
حرکت بین پایین‌ترین کره‌ها باعث حرکت کره‌های دیگر هم می‌شود.

در حالت عادی خازن‌ها با هم موازی‌اند و بعد از حرکت هم با هم سری می‌شوند.

مولد پالس مارکس
Marx Generator

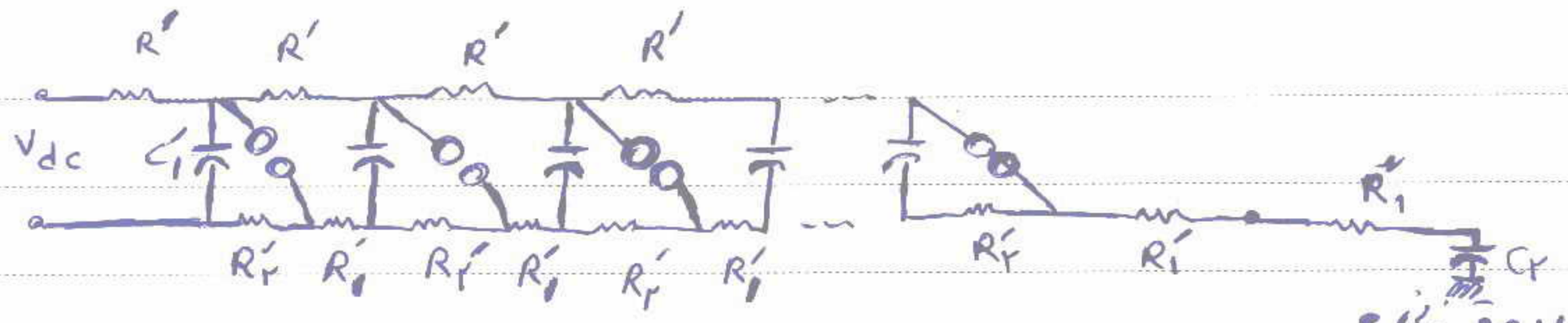


$\frac{1}{T} C'_{eq}$ $\quad$ nR'



در طبقه آخر به ولتاژ nV_{dc} خواهیم رسید.

www.iran-ieee.com



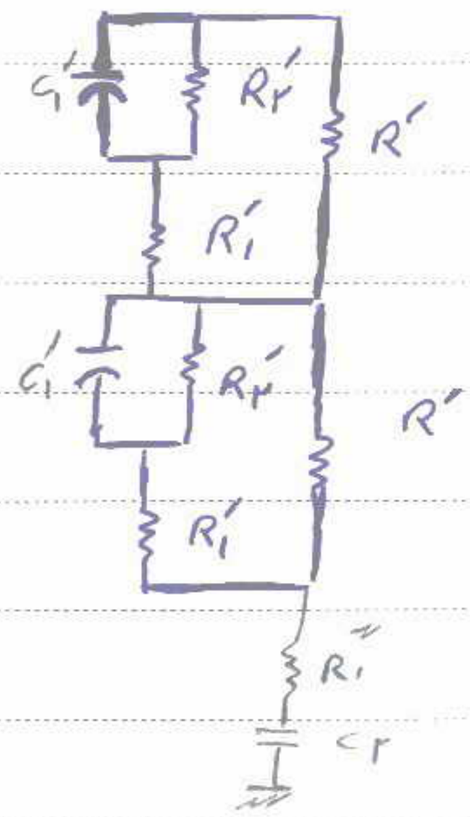
بعد از جمع زدن ۸

ضمن اینکه مقاومت‌های R'_2 با هم موازی می‌شوند

همچنین با R'_1 سری می‌شود و کل این مجموعه با R' موازی می‌شود

$$\frac{1}{C_1} = \sum \frac{1}{C'_1}$$

$$R_1 = R''_1 + \sum R'_1 \qquad R_2 = \cap R'_2$$



www.iran-ieee.com

Subject :

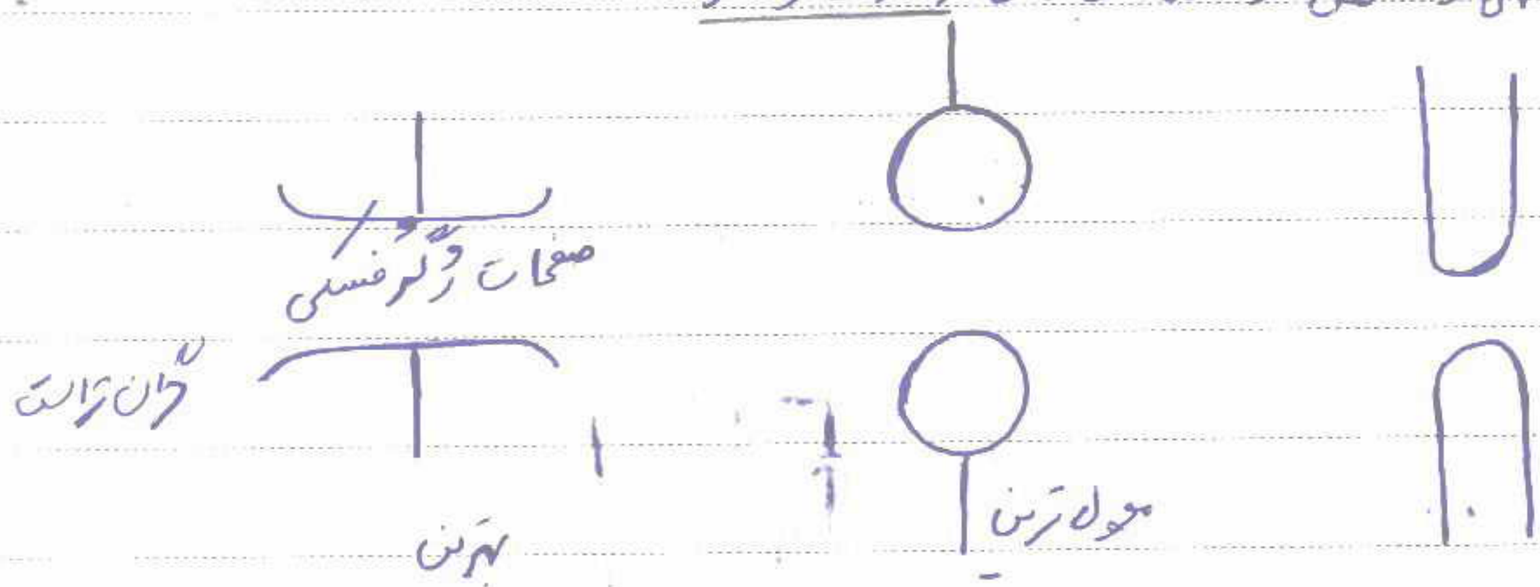
Year . Month . Date . ( )

اندازه‌گیری ولتاژ متناوب :

فاصله هوایی برای اندازه‌گیری یک ولتاژ معلوم

- فاصله هوایی : یکی از بهترین روش‌های اندازه‌گیری ولتاژها

استفاده عایق با شدت میدانی که بتواند کامل کند متناسب الکتریکی با شدت ولتاژ

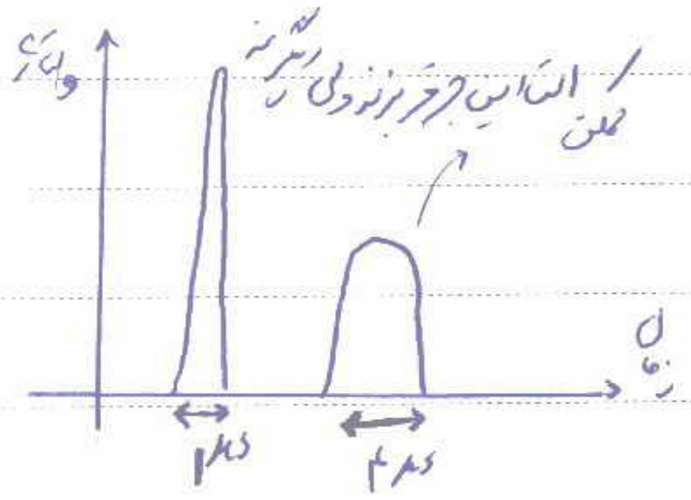


چون معلوم نیست در یک فاصله‌ی خاص چه ولتاژی است دوباره جرقه بزند، فاصله هوایی را کمی زیاد می‌کنیم تا جرقه‌ی زنی در نظر می‌گیریم

سطح کره‌ها و یا صفحه‌ها باید کاملاً تمیز باشد، در یک میلیمتر فاصله‌ی دو سر آن حداقل یک میدان الکتریکی یکنواخت برقرار کند

فاصله‌ی هوایی برای اندازه‌گیری یک ولتاژ معلومی بود

زمان لازم برای شکست الکتریکی فاصله‌ی هوایی $0.3-1\ \mu s$ است.



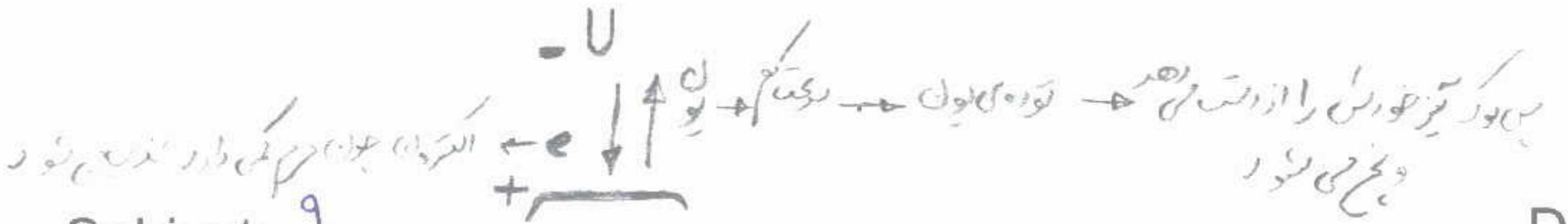
وقتی می‌خواهیم اندازه‌گیری ولتاژ انجام دهیم هر چقدر که شدت میدان یکنواخت‌تر باشد بهتر است. به همین دلیل کره‌های با قطرهای مختلف

وجود دارد که هر کدام برای فاصله‌های مختلف و ولتاژهای مختلف این آن اند.

(معمولاً در آزمایشگاه تأکید فاصله‌ی بخصوصی دقیق است و دقت اندازه‌گیری دارد)

PAPCO

www.iran-ieee.com



Subject:..... Date: / /

فاصله هوایی	DC	AC	ضربه
۱cm	V_1	V_1'	V_1''
۲cm	V_2	V_2'	V_2''
۳cm	V_3	V_3'	V_3''
۴cm	V_4	V_4'	V_4''

در ولتاژ DC چون ولتاژ ثابت است زمان لازم برای جرقه زنی را داریم.

در ولتاژ AC زمان لازم برای جرقه زنی را تقریبا داریم.

ولی در ولتاژهای ضربه، زمان لازم برای جرقه زنی را نداریم.

پس جدول بزرگی ولتاژهای AC، DC و ضربه فرق دارد.

در مقالات دو کره دو صفحه در پلاریته های مختلف ولتاژ DC نباید ولتاژ شکست زیاد فرق کند. اول در بورن هیچ فرق مشهود است

استقامت الکتریکی هوا به چگالی هوا بستگی دارد. مستقیم = یعنی با افزایش چگالی نسبی، استقامت الکتریکی افزایش می یابد

چگالی نسبی $\delta = \frac{P}{P_0} \frac{273+t_0}{273+t} = \frac{P}{P_0} \frac{T_0}{T}$

فشار زیادتر ⟸ افزایش استقامت الکتریکی

پس چگالی نسبی بیشتر

سوتعداد مقروها این بیشتر است

چون در ارتفاع فشار کمتر است

ولتاژ شکست $V_d = K_d V_{d_0}$

در شرایط نرمال ← فشار $1 atm$، رطوبت $\frac{1}{2}$، دمای هوا $20^\circ C$

چگالی نسبی δ

عوامل تاثیر گذار بر استقامت الکتریکی $V_d = \delta V_{d_0}$

معلولات بصورت ایده آل یعنی بصورت کاملا گازمانند.

۱. با افزایش رطوبت، استقامت افزایش می یابد ولی در عمل چون بار ایده آن نیست و دارای زوایا و لبه است، استقامت کاهش می یابد.

۲. تاثیر رطوبت در میدان های یکنواخت بیشتر است.

۳. پلاریته روی بر استقامت الکتریکی تاثیر دارد.

Shamime Daneshi

www.iran—ieee.com

Subject:..... Date: / /

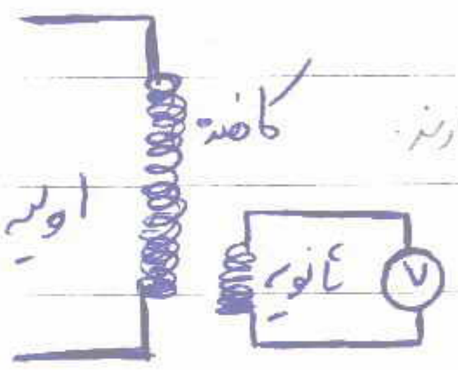
۴. رشته شیع ها تابش اشعه ی نورانی بخصوص ماورای بنفش را شدیداً تحت الکترونی تأثیر دارد چون نور انرژی وارد می تواند

زرات را برانگیزه کند و استقامت الکتریکی را کاهش می دهد.

۵. زرات پراکنده در هوا نیز می توانند در استقامت الکتریکی تأثیر بگذارند و آن را کاهش دهند.

اندازه گیری ولتاژ AC

PT:



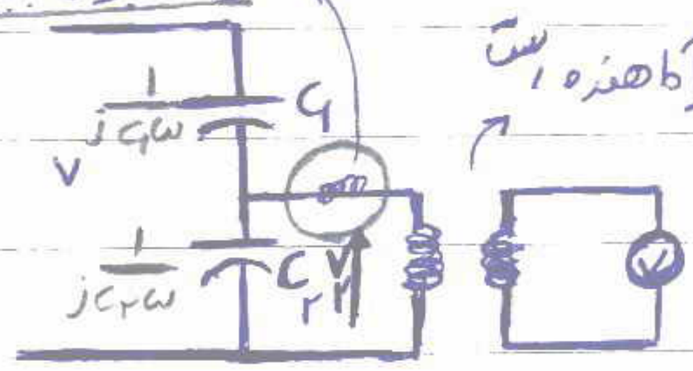
$\frac{1}{j}C V \rightarrow V = \frac{q}{C}$

$q = It$

تقسیم ولتاژ:

خازن ها برعکس امپدانس شان ولتاژ دارند. ← برای مقاومتی برعکس خود امپدانس هاشان ولتاژ دارند.

CVT



$V_2 \simeq V \frac{C_1}{C_1 + C_2}$

حکمی است برای جبران سازی اثر خازنی استفاده نکرد

۱:۱ یا کاهنده است

اگر از این ترانس برای ایزوله کردن تجهیز اندازه گیری است.

چون ممکن است اتصال کوتاهی در اولیه بوجود آید که باعث آسیب به تجهیز خواهد شد.

وسایل اندازه گیری یا موثر rms است یا متوسط mean ← ولتاژ سینوسی را می توان از رابطه $V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$ استفاده کرد چون ممکن ولتاژ

$V_{dc} = \frac{V_{max}}{\pi}$

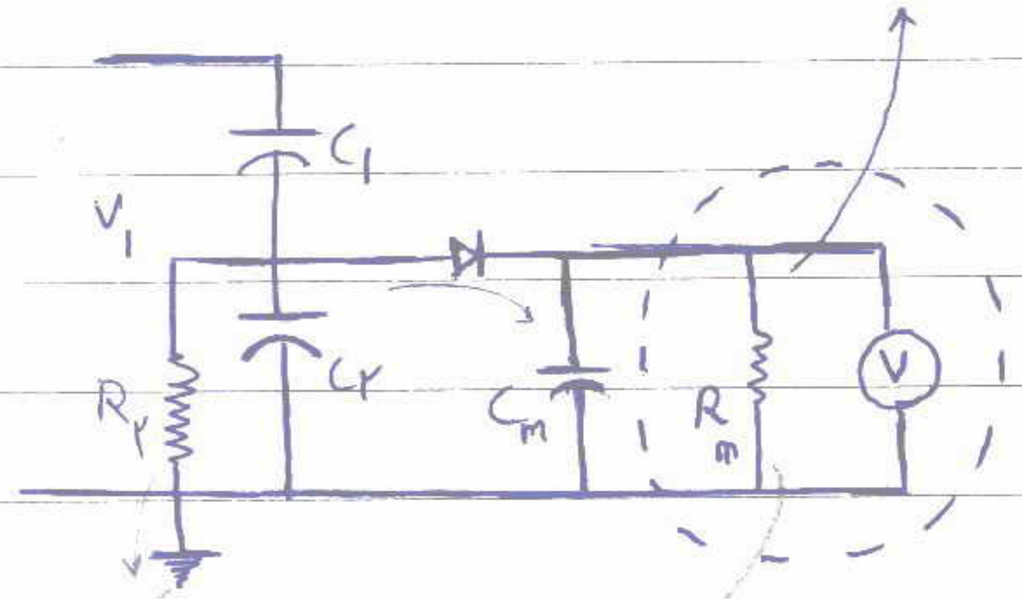
سینوسی کامل نباشد ولی از طرفی ما یک ولتاژ را لازم داریم چون:

عایق ها عمل شان با یک ولتاژ رابطه دارد نه با موج ولتاژ.

Shamime Danesh

www.iran-ieee.com

بار مقاومت خوشتاق یا مقاومتی خود ولتمتر

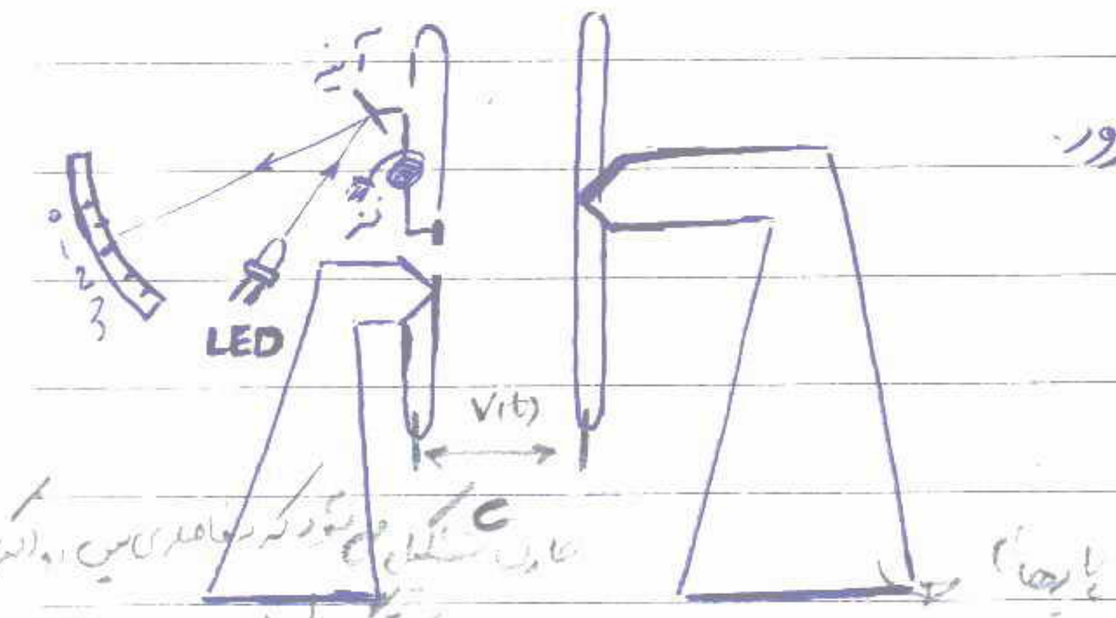


این مدار برای اندازه‌گیری یک ولتاژ است

R_2 کمتر باید لازم را تأمین می‌کند این مقاومت برای سنتش مدار لازم است.

اندازه‌گیری ولتاژ توسط ولتمتر الکترواستاتیک:

می‌توان هم برای اندازه‌گیری ولتاژ AC و هم ولتاژ DC بکار برد.



آینه را اندازه ۵ درجه عقربه‌ای را اندازه ۲α می‌چرخد و هر چه فاصله بیشتر باشد زاویه آن بیشتر خواهد شد.

$$W(t) = \frac{1}{2} C V^2(t)$$

$$F = -\frac{1}{2} \frac{dC}{dx} V^2(t) \qquad C = \frac{\epsilon A}{d-x}$$

$$F = -\frac{dW}{dx} \qquad |F| = \frac{\epsilon A V^2}{2}$$

مقدار متوسط مخدور = مخدور rms

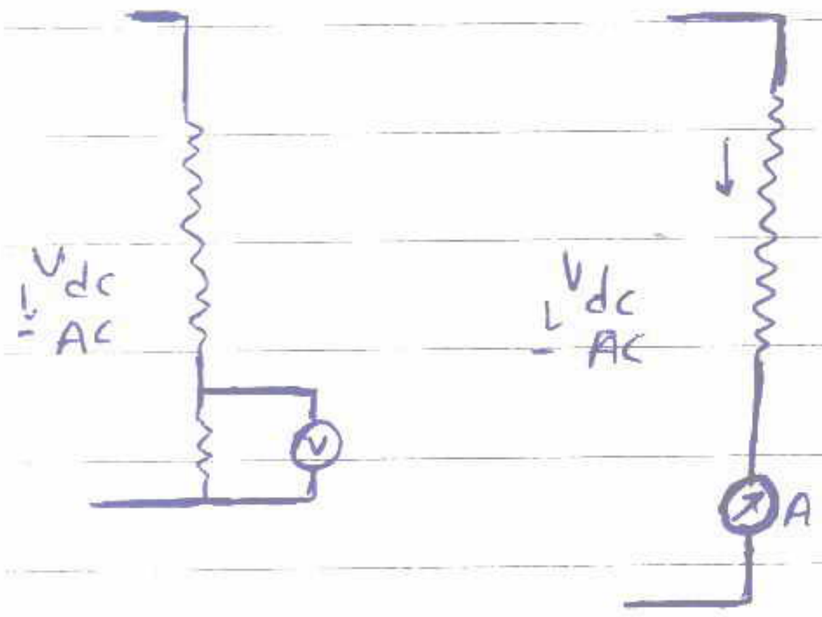
www.iran-ieee.com

Subject:..... Date: / /

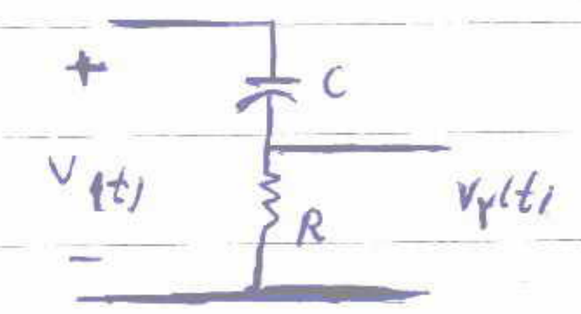
اندازه گیری ولتاژ زیاد به کمک اندازه گیری جریان:

ولتاژی که نمی‌توان به راحتی مستقیماً با ولت‌متر اندازه گرفت

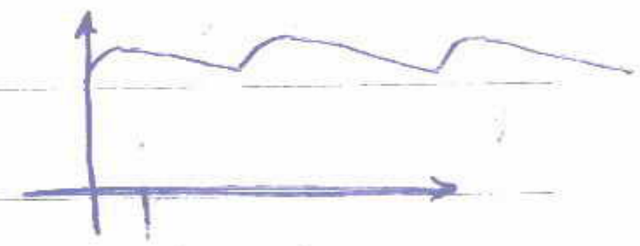
می‌توان معمولاً منبع با کمک هم مقاومت سنج



اندازه گیری ناخواسته ولتاژ خازن: (ریپل)



$$V_R(t) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V(t) = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} V(t)$$

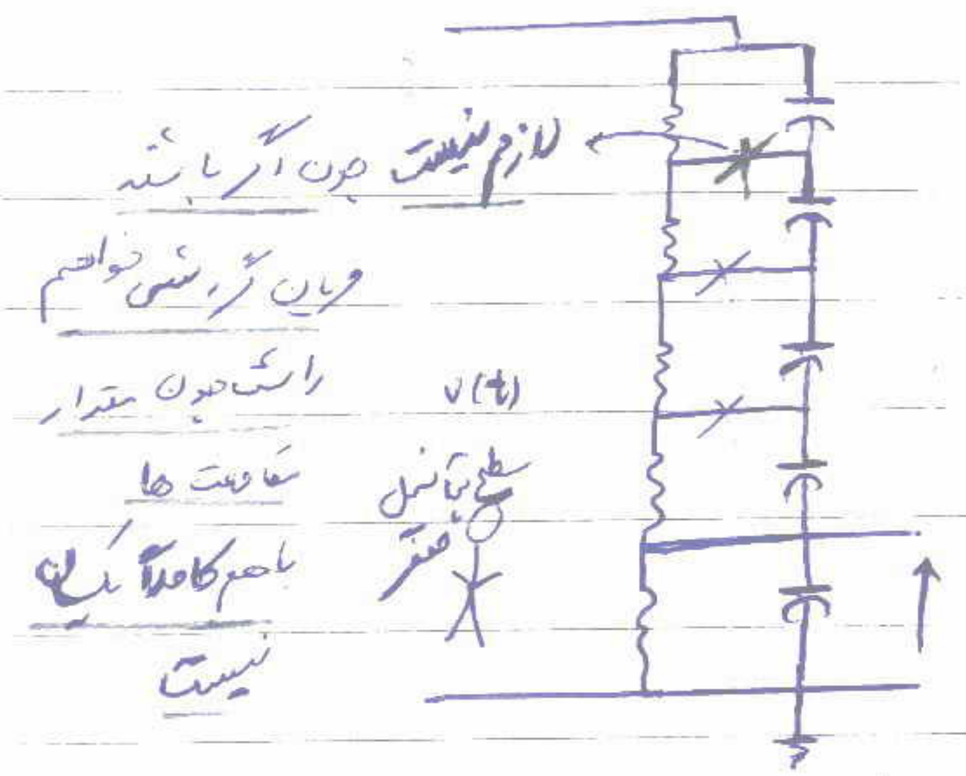


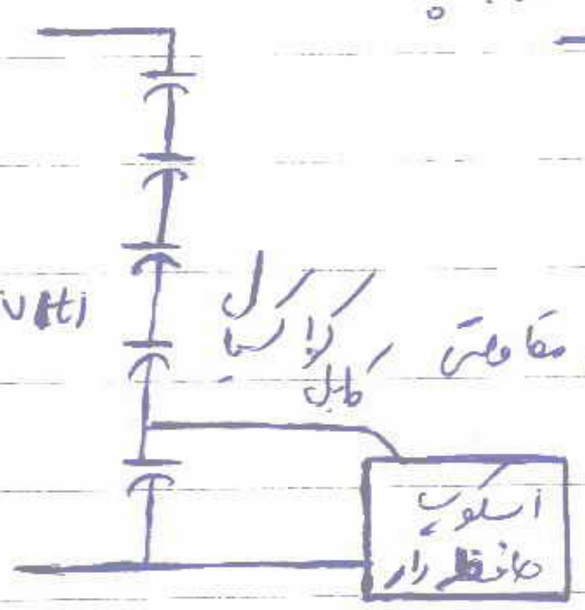
برای ولتاژ dc کامل، f=0 → ω=0 → $V_R(t) = 0$ → ریپل = 0

یعنی بخشی از dc روی خازن افتاد

و بخشی از AC روی مقاومت به شرطی خازن خوب باشد $j\omega CR \gg 1 \longrightarrow V(t) \cong V_R(t)$

اندازه گیری ولتاژ خروجی:





۱- مقسم خازنی

۲- مقسم خازنی مقاومتی

مقاومت ها باهم کاملاً یکی نیست

دقت اثر بیشتر است چون سطح تماس کمتر است

ایجاد می‌کند و تأثیر محیط اطراف کمتر است

Ghamime Dane

www.iran-ieee.com

→ خازن های سرامیکی می‌توانند برای ولتاژهای هرچه sharp اند مثل اتصال کوتاه عمل نمایند.

وضعیت میدان های الکتریکی در عایق‌ها:

الکتریکی اندازه‌گیری
شدت میدان برای عایقت عایقی استفاده می‌شود نه ولتاژ.

ضریب استفاده شوایر $\eta = \frac{E_{mean}}{E_{max}} = \frac{V_b}{E_{max}\cdot d} = \frac{V_b}{V_{max}}$

V_b ولتاژی است که میدان را در این فاصله E_{max} می‌کند

$E_{mean} = \frac{V_b}{d}$ (متوسط) میدان در بین دو الکترود ولتاژ دو الکترود فاصله دو الکترود

$E_{max} = \frac{V_{max}}{d}$ میدان ماکزیمم

هرچه بین الکترود را یکنواخت‌تر کنیم ولتاژ قابل تحمل عایق بالاتر خواهد بود. یعنی با ایجاد ۱۰۰ درصد یکنواختی

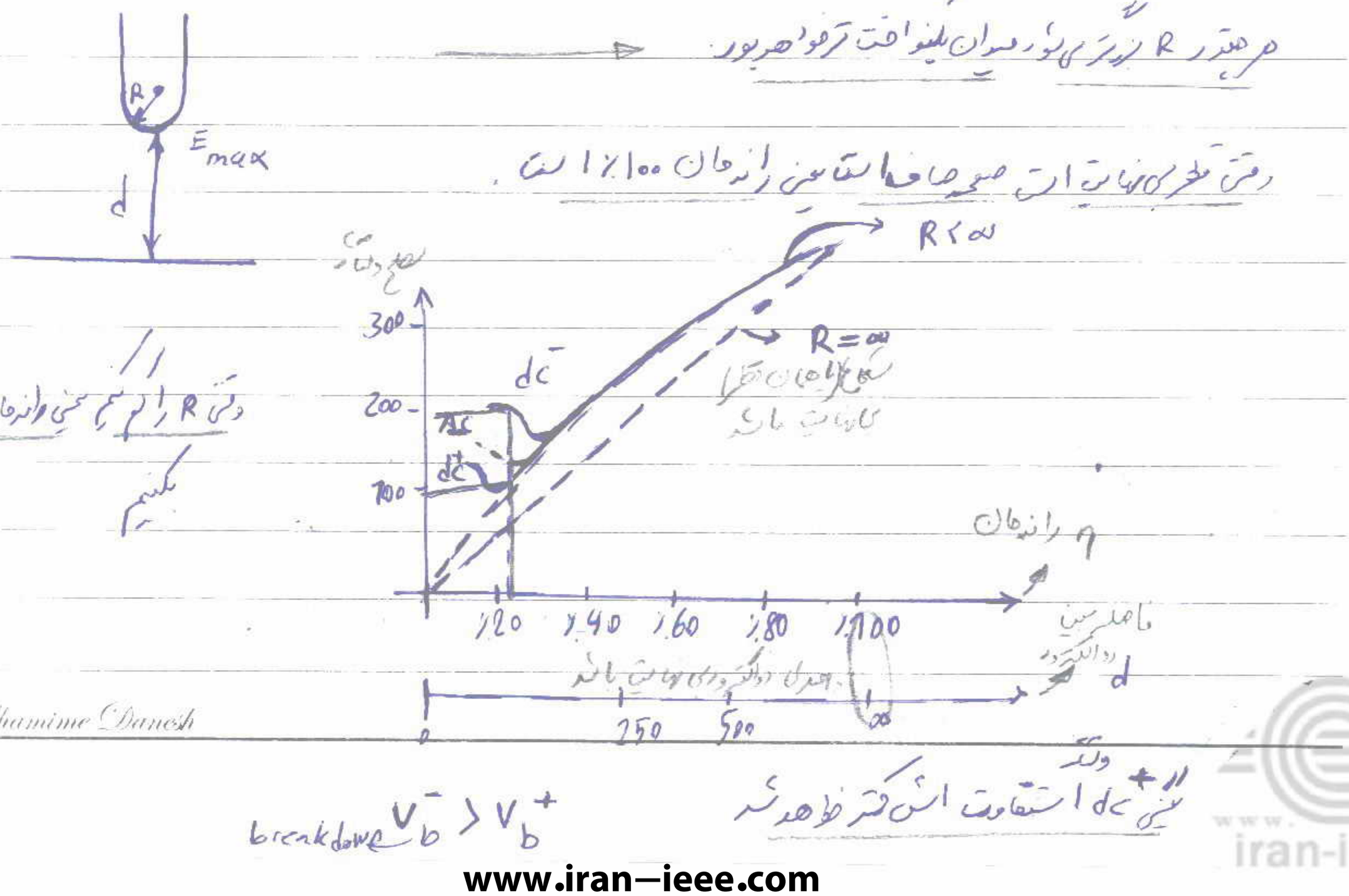
$V_b = E_{max} \cdot d \cdot \eta$

شدت میدان را هوا می‌تواند در فضای یکنواخت تحمل کند

$V_b = 26.6 \ KV/cm$ → با اثر مان ۵۰٪

هرچه R بزرگتری بود میدان یکنواخت‌تر خواهد بود.

وقتی $R \to \infty$ یکنواختی صد درصد است یعنی با اندازه ۱۰۰٪ است.



وقتی R را کم کنیم یعنی با اندازه ۱۰۰٪ است

$V_b^- < V_b^+$ breakdown

یعنی dc^+ استقامت اش کمتر ظاهر شد

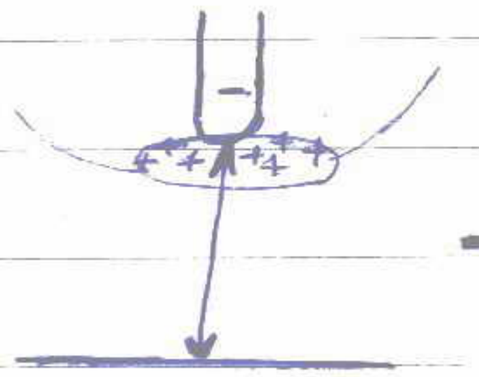
www.iran-ieee.com

Subject:...(...)... - جایی که پلاریتی بردار منفی باشد (جهت الکترون‌ها) یعنی V_2 Date: / /

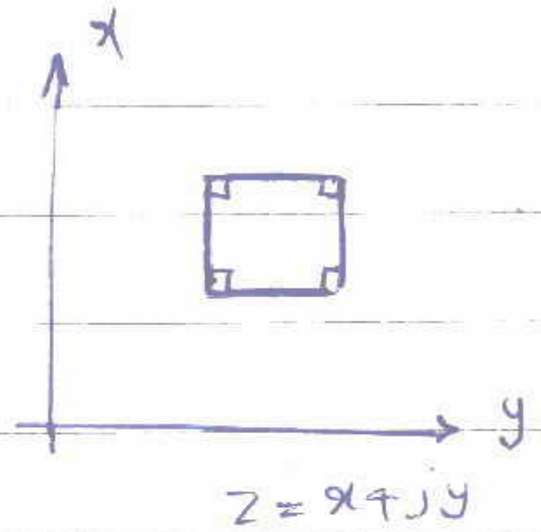
چون یون‌ها وزن‌شان بیشتر است و سرعتشان کمتر است پس یک تجمع از یون‌ها را در اطراف بردار خواهیم داشت.

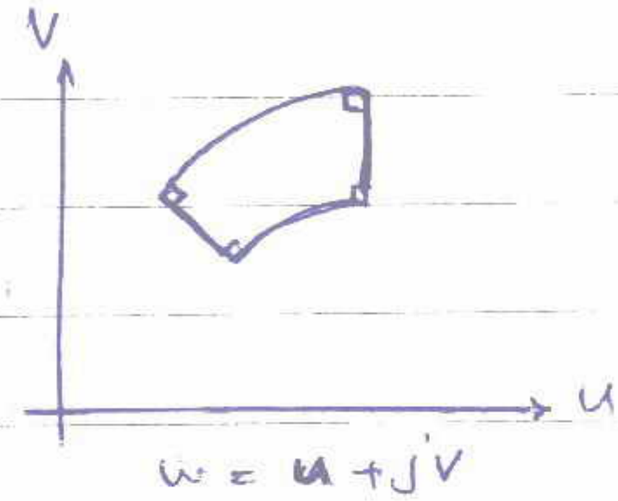
- چون آنقدر ارتفاع بزرگ‌تری بردار در بردار حرکتش در خودش ضرب خواهد بود و تجمع یون‌ها تأثیری نخواهد

داشت.



روش ۱: نگاشت هندسی





اگر تابع تحلیلی داشته باشیم و توسط آن تابع یک شکل را از یک صفحه به صفحه‌ی دیگر ببریم زاویا تغییر خواهند کرد، شکل امکان دارد تغییر کند!

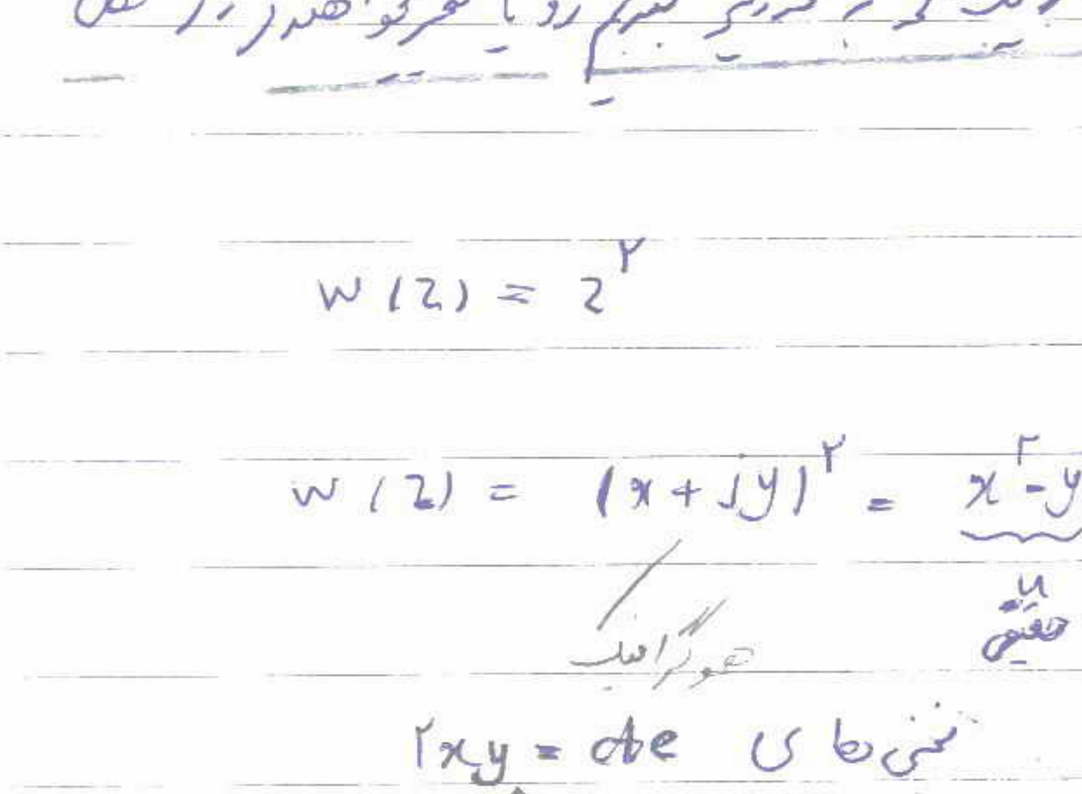
$$w(z) = z^2$$

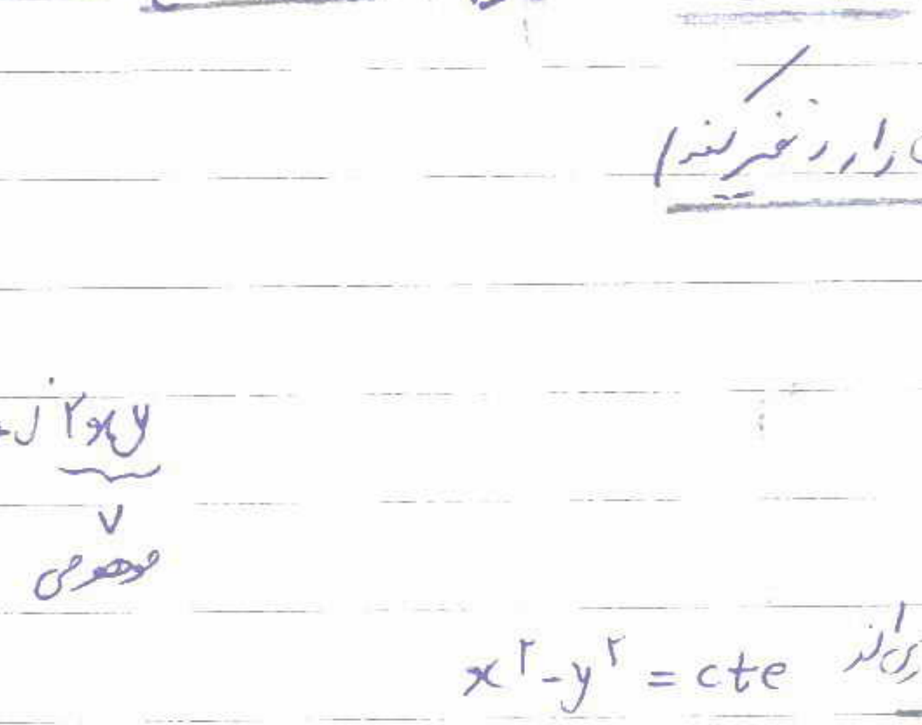
$$w(z) = (x+jy)^2 = \underbrace{x^2 - y^2}_{u} + j\underbrace{2xy}_{v}$$

هولومورفیک — حقیقی — موهومی

خانواده‌ی $x^2 - y^2 = cte$ هذلولوی‌اند

خانواده‌ی $2xy = cte$ هذلولوی‌اند





Shamloue Danesh

www.iran-ieee.com

www.iran-ieee.com

Subject: ۱۲ Date: / /

$w = \arcsin \frac{z}{a} \longrightarrow z = a \sin w$

$z = x + jy = a \sin(u + jv) =$

$= a \sin u \cos jv + a \cos u \sin jv$

$= a \sin u \cosh v + ja \cos u \sinh v$

$x = a \sin u \cosh v$

$y = a \cos u \sinh v$ ←

$\cos jv = \cosh v$

$\sin jv = j \sinh v$

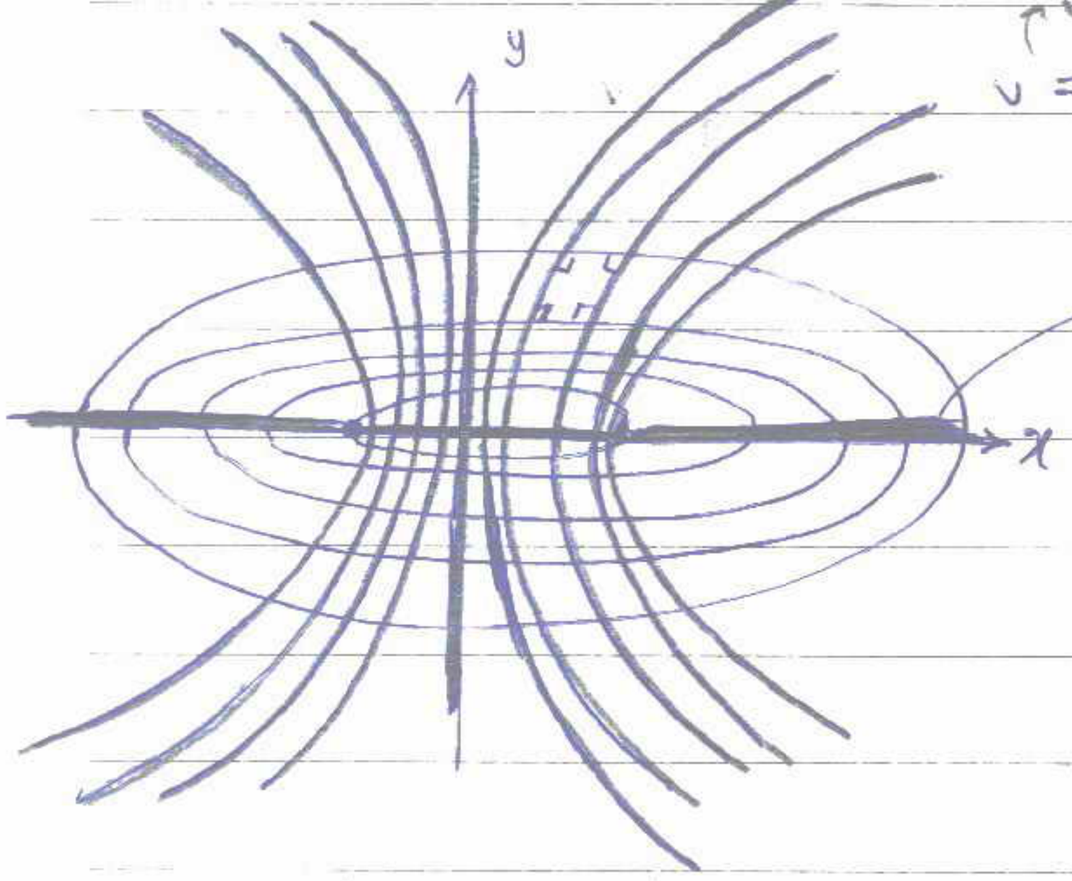
$\left(\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \quad , \quad \cosh^2\theta - \sinh^2\theta = 1 \right)$

$\sin^2 u + \cos^2 u = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{a^2 \cos^2 hv} + \frac{y^2}{a^2 \sin^2 hv} = 1$

$\frac{x^2}{\cos^2 h u_1} + \frac{y^2}{\sinh^2 v} = a^2$

↑ "cte" ↑ "cte"

$v = cte$ خم‌های بیضی انه



میدان بین دو دیلی

میدان بین دو بیضی

میدان بین دو هذلولی

$\cosh^2 v - \sinh^2 v = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{a^2 \sin^2 u} - \frac{y^2}{a^2 \cos^2 u} = 1$

$\frac{x^2}{\sin^2 u} - \frac{y^2}{\cos^2 u} = a^2$

هذلولی $x^2 - y^2 = cte$

$u_1 = cte$

← برای کردن این تابع تحلیلی کار سختی است برای شکل‌های متداول در طبیعت این کار را انجام داده‌اند

Ghamime Darvish

www.iran-ieee.com

Subject:..... Date: / /

$$Z = \frac{a}{\pi}(W + 1 + e^{W})$$

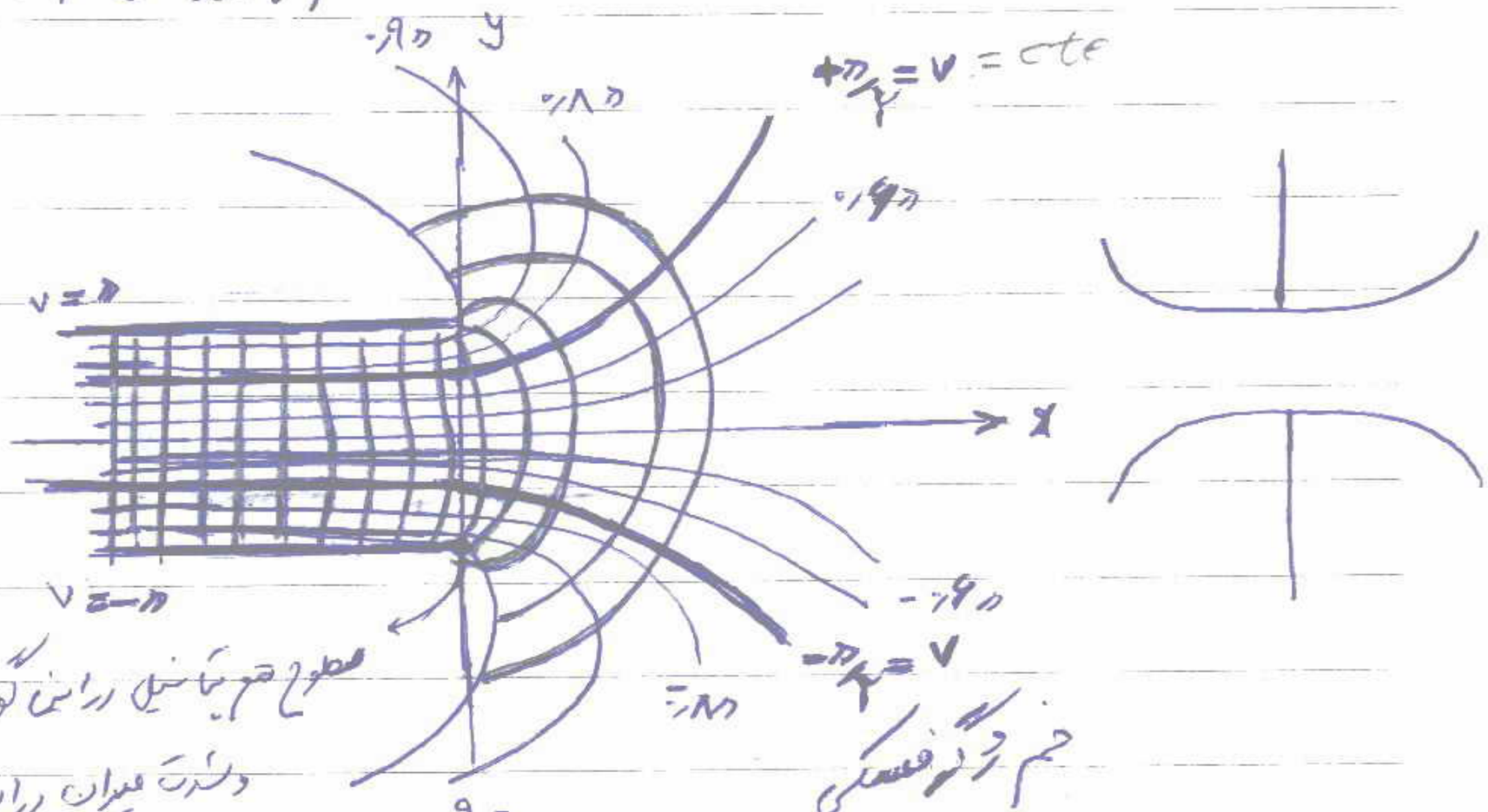
$Z \to x + jy$, $W \to u + jv$

(Maxwell)

نگاشت کانفورم

$$x = \frac{a}{\pi}(u + 1 + e^{u}\cos v)$$

$$y = \frac{a}{\pi}(v + e^{u}\sin v)$$



سطوح هم پتانسیل را این گونه خطوط خیلی هم نزدیک می شوند و شدت میدان در این نقاط خیلی زیاد است

حجم ژوکوفسکی

مانند

بیشترین استفاده الکترومغناطیس با

بهترین جواب برشدت میدان یکنواخت بدست می آید که برای ایجاد میدان یکنواخت بهترین هندسه، هندسه ای است که شکل حجم ژوکوفسکی

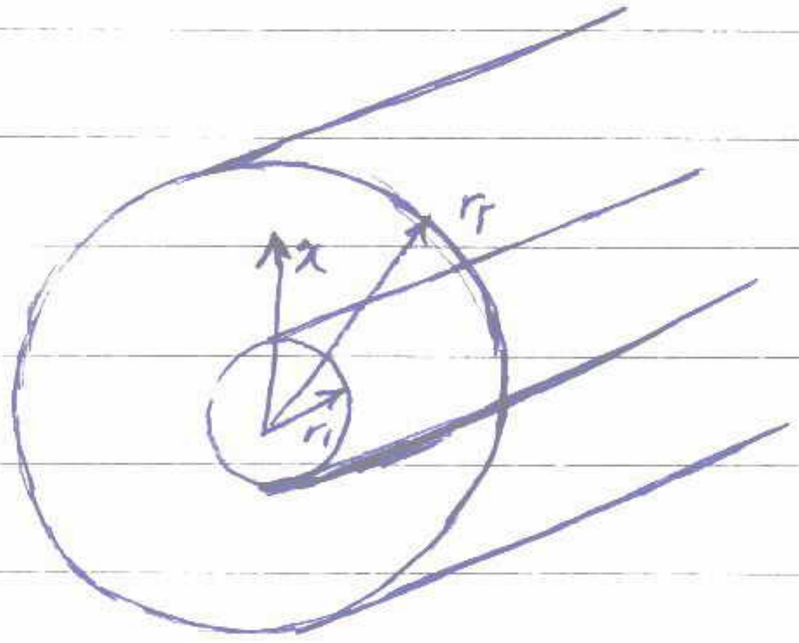
از هندسه های $\theta = \pi/4$ و $\theta = \pi$ هم می توان برای میدان یکنواخت استفاده کرد اما هندسه بزرگتر ظاهر شده و هزینه زیاد خواهد شد و هندسه $\theta = \pm\pi/4$ و $\theta = \pm\pi$ خواهند شد ولی میدان یکنواخت نخواهد بود

ولی حجم ژوکوفسکی بهترین حالت بین این دو هندسه است.

www.iran-ieee.com

استفاده از
۲ روش شکل های ساده

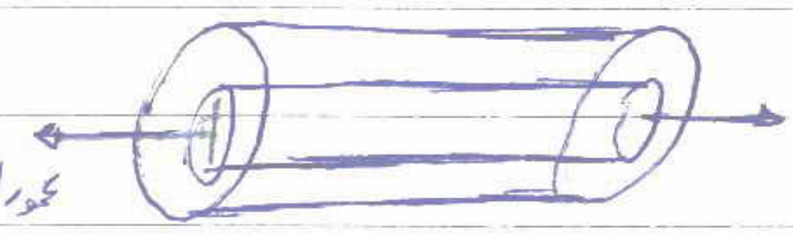
میدان الکتریکی روستوانه توپر و متحدالمرکز



$$\oint D.ds = \sum q$$

$$۲\pi x . \epsilon E_x = \sum q$$

روا استوار متداخل و متحدالمرکز



$$E(x) = \frac{Q/l}{۲\pi\epsilon}\frac{۱}{x} = \frac{V}{\ln|r_۲/r_۱|}\frac{۱}{x}$$

با بسط

بحوراست

پس $\oint D.ds = 0$ می شود

$$V_۱ - V_۲ = \ominus \int_{r_۱}^{r_۲} E.dr$$

$$-V = -\frac{q}{۲\pi\epsilon l}\int_{r_۱}^{r_۲}\frac{dr}{r} = -\frac{q}{۲\pi\epsilon l}\ln\frac{r_۲}{r_۱}$$

روکره متداخل و متحدالمرکز

$$۴\pi x^۲ . \overrightarrow{\epsilon E_x} = Q \longrightarrow E(x) = \frac{Q}{۴\pi\epsilon}\frac{۱}{x^۲} = \frac{V}{(R_۲-R_۱)/R_۱R_۲}\frac{۱}{x^۲}$$

در دو استوانه:

$$E_{max} = \frac{V}{\ln\frac{r_۲}{r_۱}} \times \frac{۱}{r_۱}$$

اگر $r_۲ = r_۱$ آنگاه E_{max} از این رابطه $\ln ۱ = ۰$

اگر $r_۱ \to ۰$ آنگاه E_{max} از این رابطه $\frac{۱}{۰} = \infty$

پس $r_۱$ را حقیر انتخاب کنیم به ازای آن $r_۲$، بیشترین میدان ماکزیمم (E_{max}) مینیمم شود.

$$\left.\frac{dE_{max}}{dr_۱}\right|_{r_۲=cte} = ۰ \longrightarrow \boxed{r_۲/r_۱ = e = ۲,۷}$$

نسبت شعاع بیرونی به شعاع داخلی ۲,۷ است

و این نکته در تمام کابل هاست های دارای هم محور کاربرد دارد

$$\frac{d}{dx}\ln u = u'/u$$

Shamime Danesh

www.iran-ieee.com

Subject:..... در دو کره متحدالمرکز : Date: / /

$$E_{max} = \frac{V}{\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}} \frac{1}{R_1^2}$$

اگر $R_1 = \infty$ ← $E_{max} = \infty$

اگر $R_1 = R_2$ ← $E_{max} = \alpha$

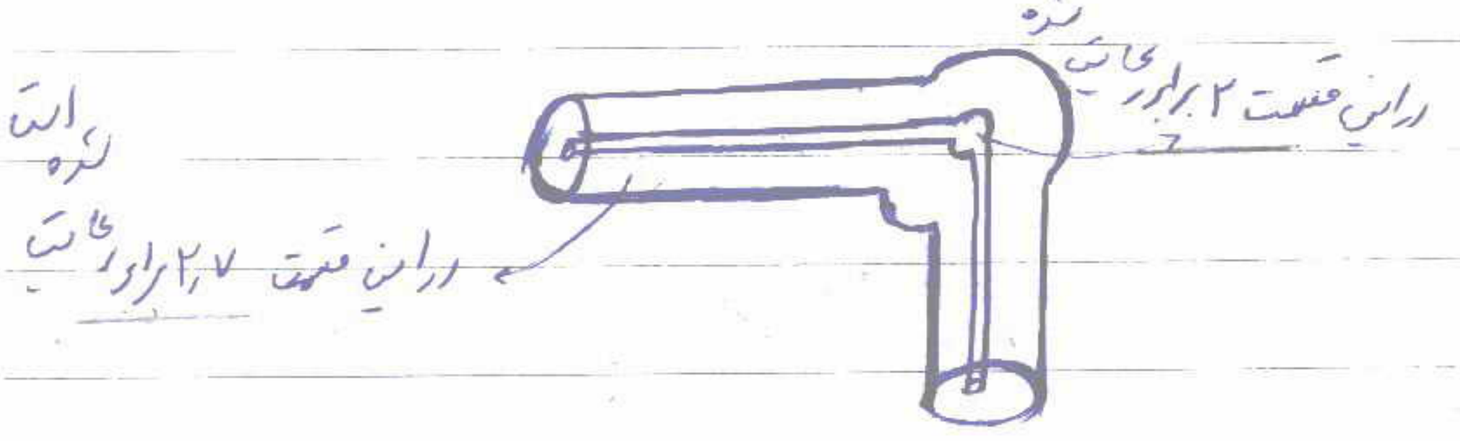
$R_1 \to \infty$ ↓ $R_1 \to \infty$

$E_{max} = \frac{V \times \infty}{R_2 - R_1 = cte} = \infty$ × α

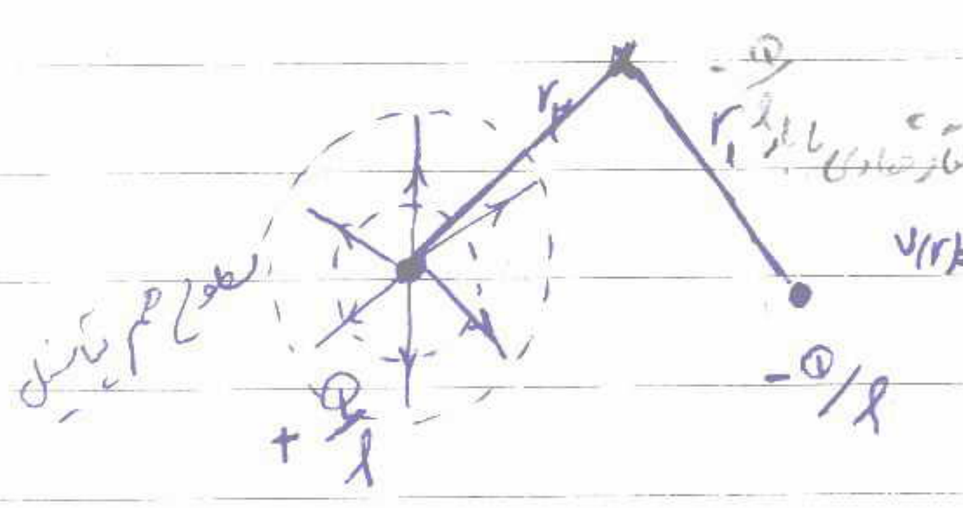
طراحی بیشتر تا شعاع آن بیشتر شود احتمال اضطراب کمتر شود

$$\frac{d E_{max}}{dR_1}\Big|_{R_2 = cte} = 0 \longrightarrow R_2 = 2R_1$$

ریسک‌های GIS :



میدان بین دو هادی موازی :

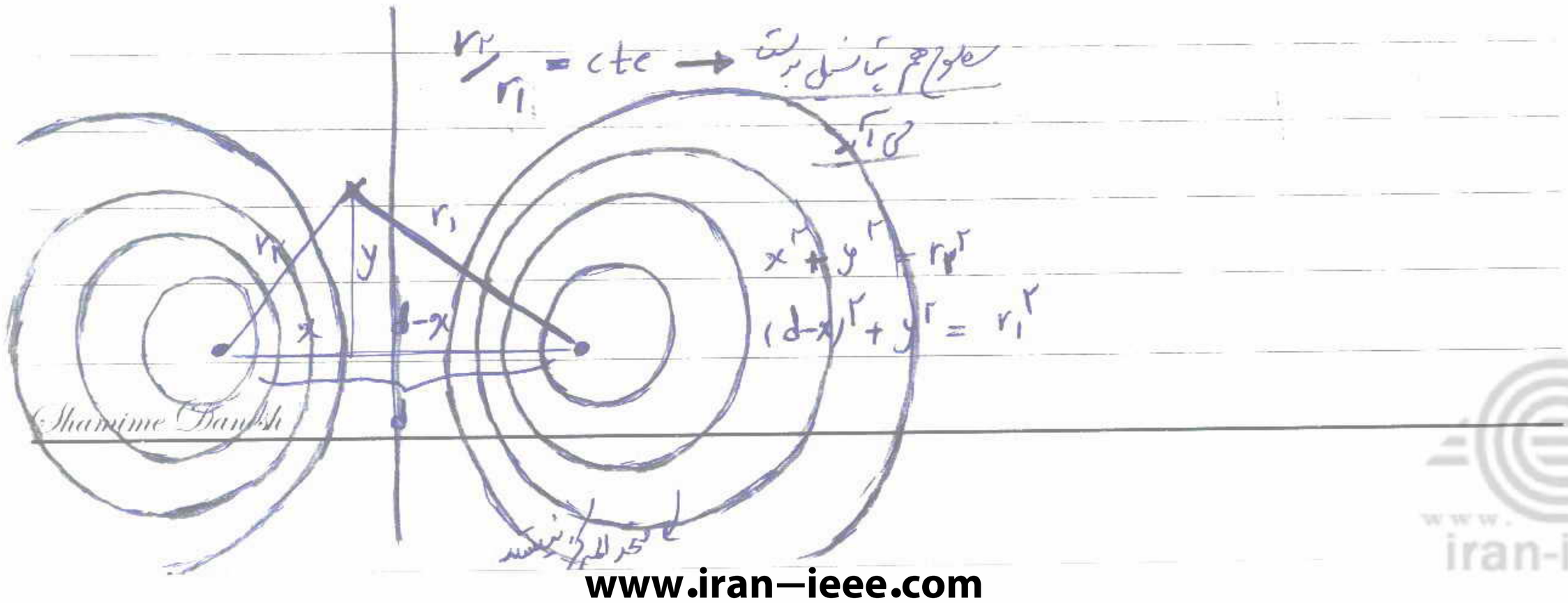


$$V(r) = -\frac{Q/l}{2\pi\epsilon} \ln r + K$$ ← با داشتن یک مقدار پتانسیل ثابت K بدست می‌آید

$$V(r) = -\frac{Q/l}{2\pi\epsilon} \ln r_1 + K + \frac{Q/l}{2\pi\epsilon} \ln r_2 + K$$

$$V(r) = \frac{Q/l}{2\pi\epsilon} \ln r_2/r_1 + 2K = \frac{Q}{2\pi\epsilon l} \ln r_2/r_1$$

$r_2/r_1 = cte$ → سطوح هم پتانسیل برابر



www.iran-ieee.com

$$\frac{(d-x)^2+y^2}{x^2+y^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = k^2 \longrightarrow \left(x+\frac{d}{k^2-1}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{kd}{k^2-1}\right)^2$$

معادله دایره‌ای که کره‌ی $(0, 0)$ و $\frac{d}{k^2-1}$ است

شعاع $\frac{kd}{k^2-1}$

روش‌های تعیین میدان و پتانسیل (اندازه‌گیری)

۱- استفاده از ترسیم میدان روی کاغذ کربن‌دار

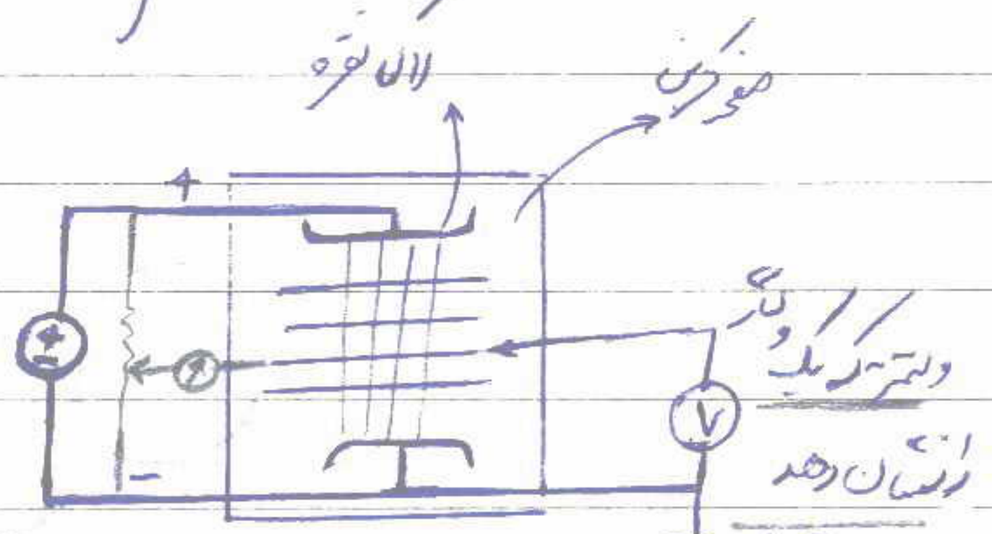
فقط خاصیت میدان‌های پایستار و یا میدان‌هایی که در یک جهت ثابت می‌مانند.

برای یک دی‌الکتریک

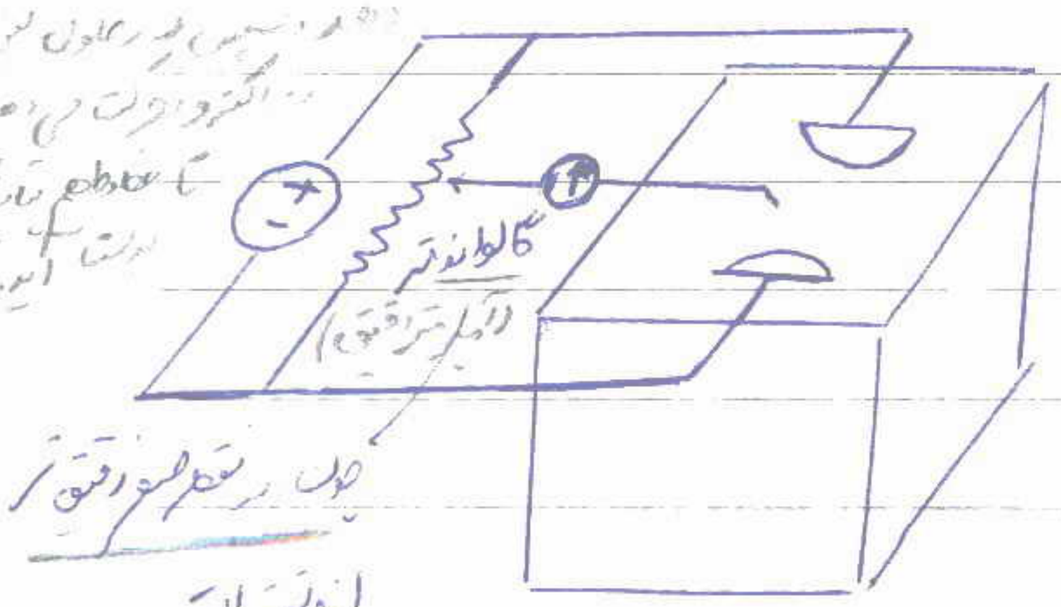
$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ $\quad \Phi = \int D \cdot dA$ $\quad div\, \vec{D} = 0$

برای یک هادی

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$ $\quad I = \int J \cdot dA$ $\quad div\, \vec{J} = 0$



۲- استفاده از پدیده الکترولیت: ساخت لایه‌های هم‌پتانسیل



www.iran-ieee.com

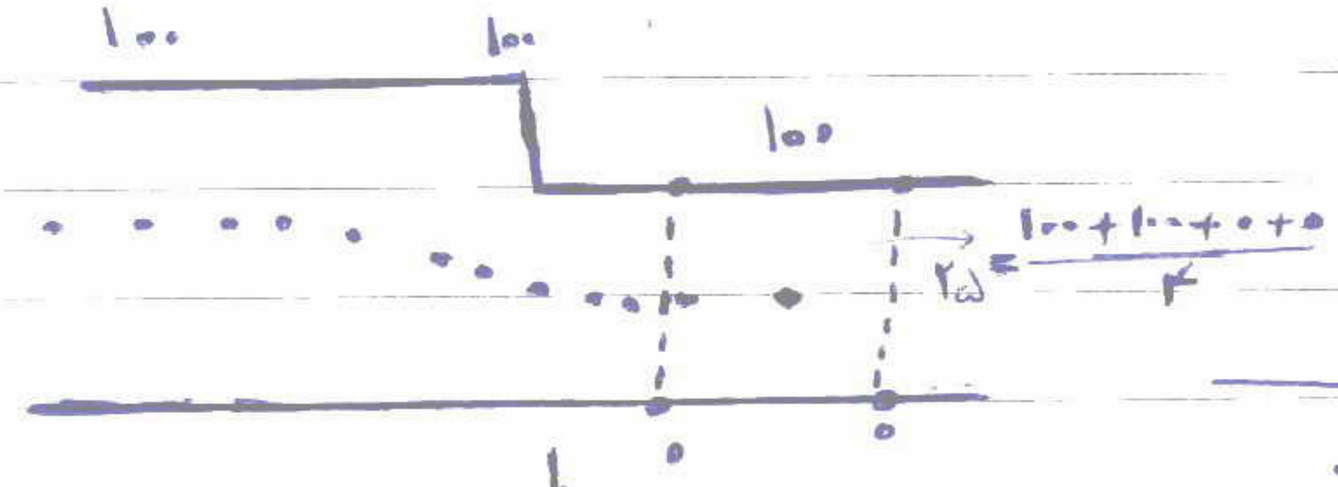
ولی اینجوری راه نمیره هم وجود را رد نمی‌کنند چرا ← برطرف شدن این ماشین‌ها آنگونه خواهد بود ✓

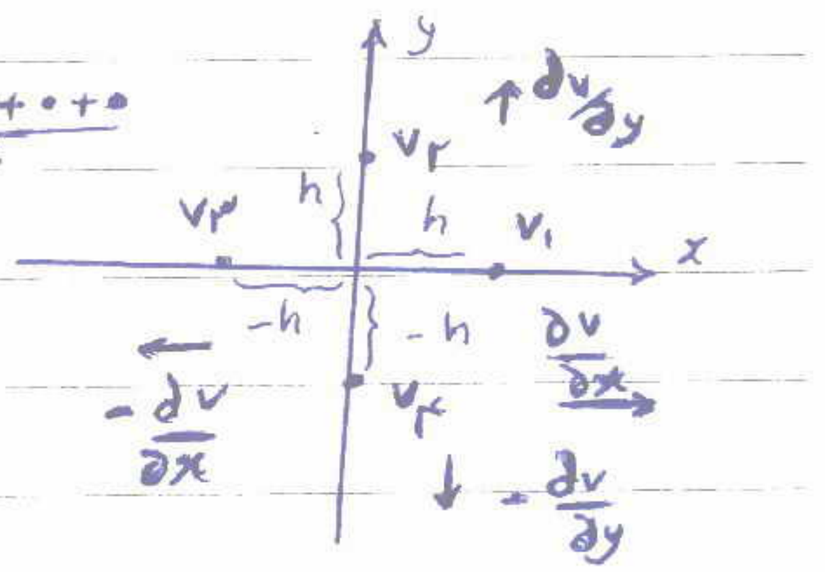
سریع‌تر می‌کنند چرا ← از حال این ماشین‌ها آنگونه خواهد بود ✗

۳- استفاده از پرکاه : وسیله‌ای رو حقی با وزن کم است پرکاه در استان نشان جهت گیری می‌کند

۴- اجزای نکردور

روش





$$V_1 = V_0 + \frac{\partial v}{\partial x} dx$$

این جمله‌ها وقتی درست است که این فاصله‌ی h خیلی کوچک باشد نزدیک به مشتقات مرتبه بالاتر را هم بنویسیم

$$V_2 = V_0 + \frac{\partial v}{\partial x} dx \quad (dx = h)$$

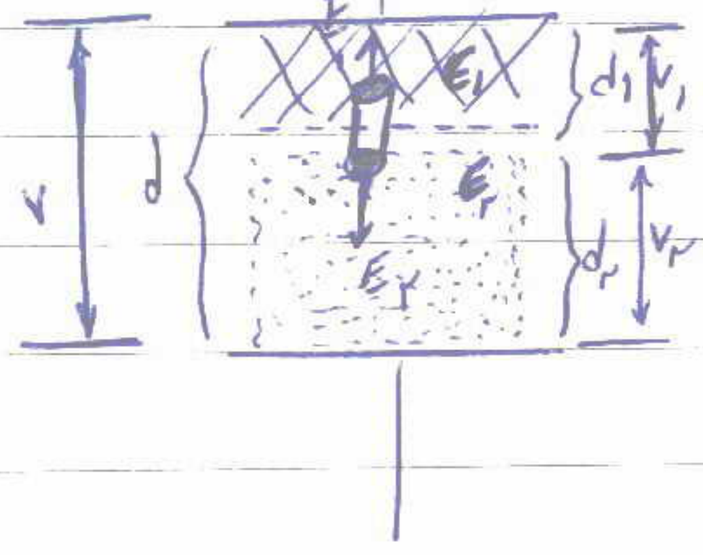
$$V_3 = V_0 + \frac{\partial v}{\partial x} dx \quad (dx = -h)$$

$$V_4 = V_0 + \frac{\partial v}{\partial y} dy \quad (dy = -h)$$

$$V_0 = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4}{4}$$

میدان الکتریکی در محیط‌های مختلف : رفتار میدان در سطح جدایی

عبورات :



هدایت

مکعب ایده‌آل کمی $\sigma = 0$ پس عبور جریان ممنوعیت

$\sigma = 0 \rightarrow \oint D \cdot ds = \sum q = 0$ در مرز دو محیط ایده‌آل بار آزاد وجود ندارد.

چون جهت فلش مخالف هم است

$$\int D_1 - \int D_2 = 0$$

$$D_1 = D_2$$

$$\epsilon_1 \vec{E}_1 = \epsilon_2 \vec{E}_2 \rightarrow \left(\frac{\vec{E}_1}{\vec{E}_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\right)$$

www.iran-ieee.com

$$V = V_1 + V_2 = E_1 \cdot d_1 + E_2 \cdot d_2 = E_1 d_1 + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 d_2$$

$$E_2 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1$$

$$\boxed{E_1 = \frac{V}{d_1 + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} d_2}} \quad (2)$$

$$\boxed{E_2 = \frac{V}{d_2 + \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} d_2}} \quad (1)$$

نقطه ۱/۱

اگر فاصله صفحات خازن خیلی کم باشد: $\boxed{E = \frac{V}{d_1 + d_2}}$

if $\epsilon_2 \gg \epsilon_1 \longrightarrow \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = 0$, $\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \approx \infty$

← خریبذیری الکتریک هیچ ربطی به استحکام عایق ندارد

و همه‌ی عایق‌ها ضریب دی الکتریک نسبی شان بزرگتر از ۱ است و ضریب دی الکتریک آن خلاء خیلی بزرگ است

بیشتر خواهد شد

هم هوا و هم عایق خیلی با هم تفاوت دارند پس اگر خازنی آن هم با دی الکتریک هوا پر شده باشد

لایه بار هوا

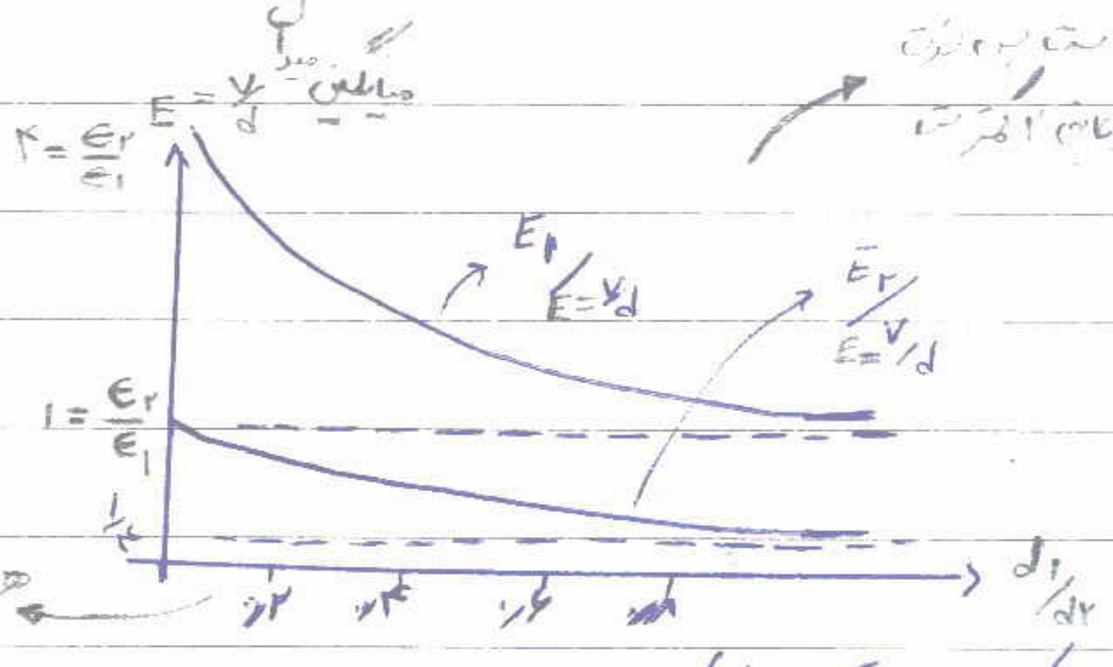
شدت میدان زیاد در نتیجه جرقه

شدت میدان در این لایه‌ی بار هوا خیلی بیشتر از هوا

شدت میدان هوای کناری که فقط از هوا تشکیل شده

عایق استفاده کرده برعکس دلیل در عایق کاری باید دقت کنید هوا بگیرد!

کابل شوی یعنی سر کابل آلمینیوم را کشیده بود و آلمینیوم عایق است در نتیجه در مقابل ولتاژ جریان مقاومت شان زیاد می‌شود و حرارت زیاد می‌شود و می‌سوزد.



هرچقدر d_1 کوچکتر باشد شدت میدان در d_1 بیشتر خواهد بود.

هرچقدر d_1 بزرگتر شود شدت میدان کمتر می‌شود.

$E \uparrow \leftarrow d \downarrow$

$E \downarrow \leftarrow \epsilon \uparrow$

در عایقی که ϵ بزرگتر است شدت میدان کمتر است.

$D_1 = D_2 \rightarrow$

Shamima Danesh

www.iran-ieee.com

اگر دو عایق را بصورت مخلوط در بیاوریم تا زمانی که در سطح ماکروسکوپی مخلوط شده باشند رابطه فنی را خواهد داشت

ولی اگر خیلی خوب مخلوط شده باشند که بتوان گفت یک ماده است می‌توان گفت: $D = \epsilon_{res} E$ (منتجه)

$D_1 = D_2$

$D = \epsilon_{result} E = \epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2$ (۳)

$\epsilon_{res} = \dfrac{1}{\frac{(d_1/d)}{\epsilon_1} + \frac{(d_2/d)}{\epsilon_2}}$ $\left(\frac{V}{d}\right)$

d_1 میزانی که از عایق ۱ داریم

d_2 میزانی که از عایق ۲ داریم

$\epsilon_{res} = \dfrac{1}{\frac{V_1}{\epsilon_1} + \frac{V_2}{\epsilon_2}}$

ϵ_1 ← حجم نسبی عایق مقرین

نتایج استفاده از:

$\left(\epsilon_{res} = \dfrac{1}{\frac{v_1}{\epsilon_1} + \frac{v_2}{\epsilon_2} + \frac{v_3}{\epsilon_3} + \cdots + \frac{v_n}{\epsilon_n}}\right)$

v_1 و v_2 و v_3 و ... و v_n حجم نسبی عایق‌های مقرابل

که الکتریک ϵ_1 و ϵ_2 و ... و ϵ_n می‌باشند.

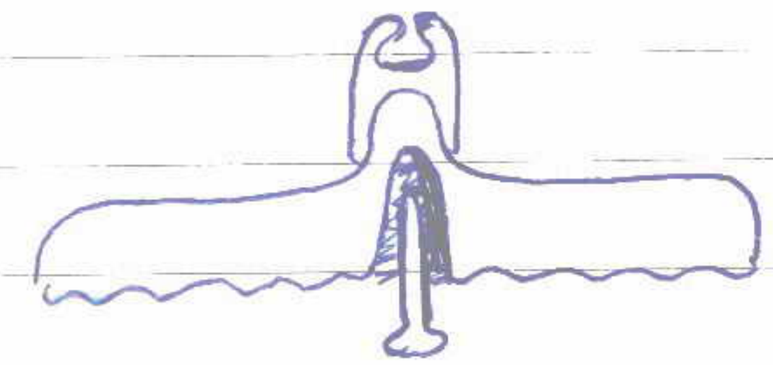
$v_1 + v_2 + v_3 + \cdots + v_n = 1$

$\boxed{\sum v_i = 1}$

دلیل استفاده از مخلوط عایق: چون عایق‌ها خواص مختلفی دارند شاید بعضی‌شان استقامت مکانیکی خوبی دارند

شاید بعضی‌شان استقامت الکتریکی خوبی دارند و ...

کپ فلزی

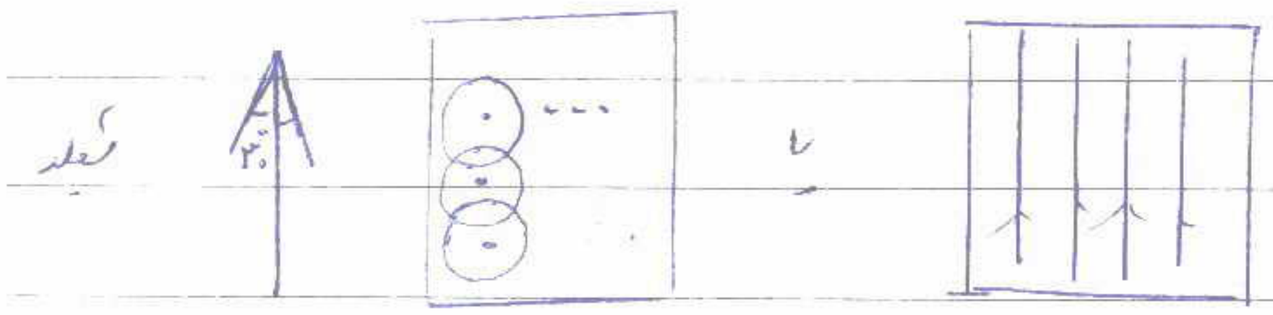


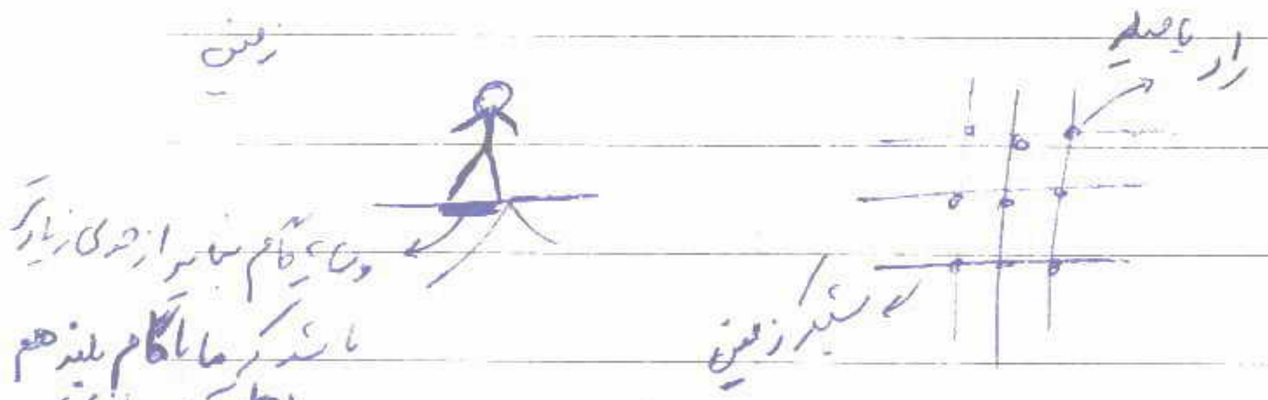
پین فلزی

Shamime Danesh

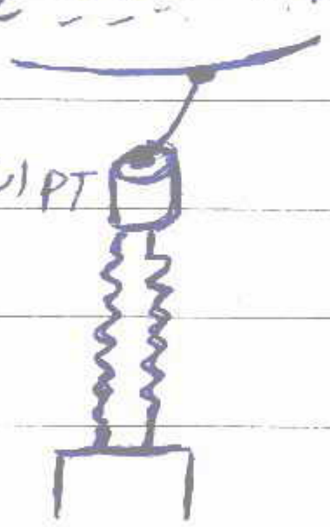
www.iran-ieee.com

- هر سه ۲۰kV ، کرنگ در ست ۱۳۰kV : ۱۵-۱۶ = ۲۳۰/۲۰ + d ↑



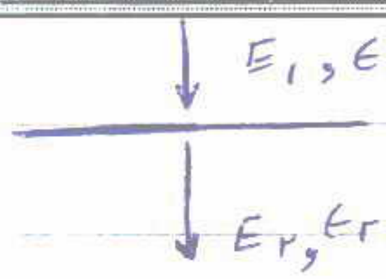


- مقره ها چین دار و جنسشان از تا گر باران نباید کند سطح خیس و بد سطح خشک خواهد بود.



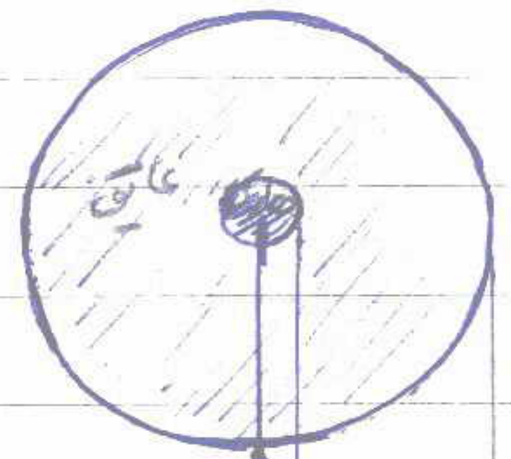
باید در هر جایی یک اتصال به زمین داشته باشیم چون اگر اتصال به زمین نداشته باشیم اگر یک فاز اتصال کند ولتاژ دو فاز دیگر ۳ برابر
به خاطر این است که آن را زمین می کنند.

www.iran-ieee.com



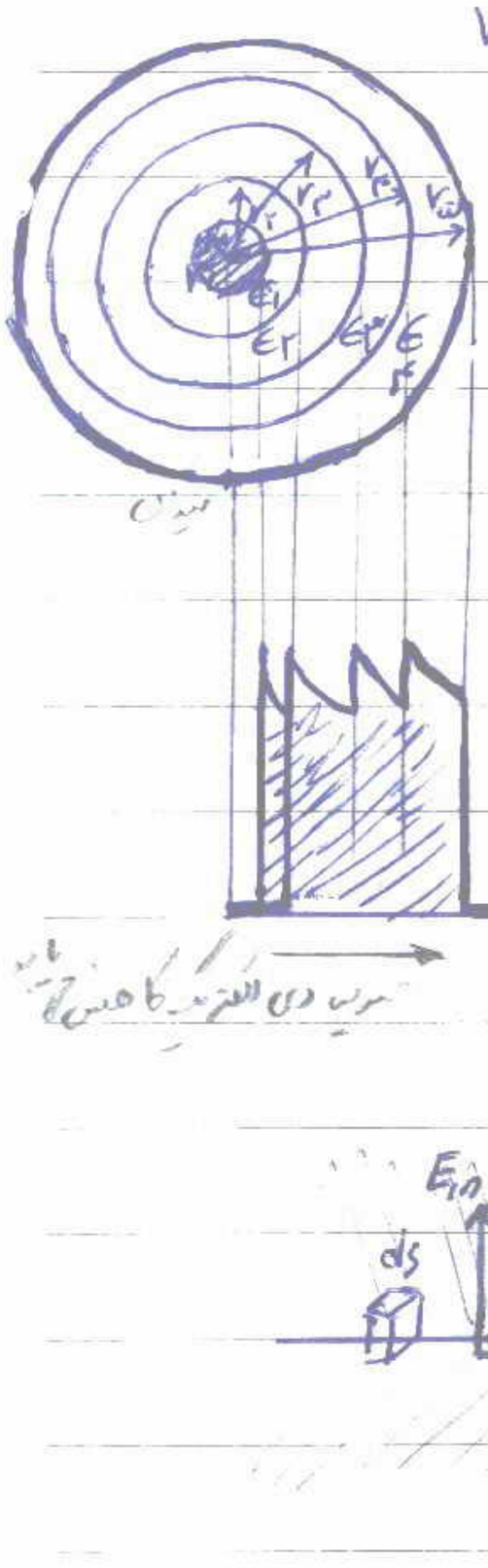
$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

راض هاال کر شوت میدان صفر است.

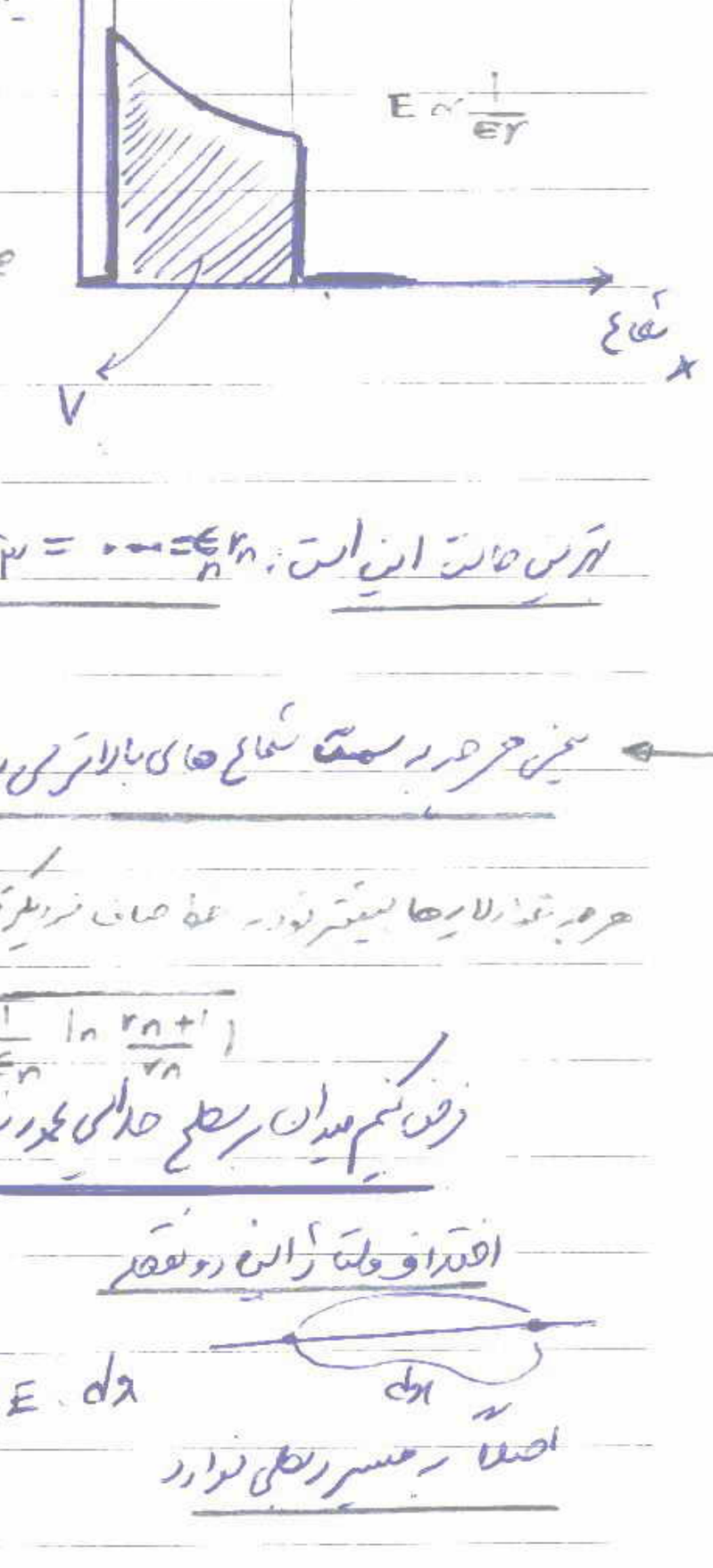


اگر شیلد را کنار باشیم در بیرون هم میدان صفر است.

$$V = \int_{\text{مسافت نوار}}^{\text{روی رد}} E\,dr$$



$$E \begin{cases} \propto \frac{1}{r} \uparrow \\ \propto \frac{1}{E} \downarrow \end{cases} \longrightarrow \frac{1}{\epsilon_2} = C \in$$



آنگاه مقدار ماکزیمم میدان ها با هم برابر می شود

$$\epsilon_1 r_1 = \epsilon_2 r_2 = \epsilon_3 r_3 = \cdots = \epsilon_n r_n$$

این حالت

همین طور به سمت شعاع های بالاتری می رویم، ϵ را بزرگتر در نظر می گیریم

هر چه شعاع لایه ها بیشتر شود، خطوط شار کمتر می شود.

$$E(x) = \frac{V}{\epsilon_2 \times \sum_{n=1} \left(\frac{1}{\epsilon_n} \ln \frac{r_{n+1}}{r_n} \right)}$$

$\frac{1}{\epsilon_2}$

در حل تمام میدان در سطح حداکثر خواهد شد:

اقتداو ولتاژ این دو نقطه

$$\oint E \cdot d\lambda$$

اصلا مسیر بسته ای ندارد

$$E_{1t}\,dx = E_{2t}\,dx \longrightarrow \boxed{E_{1t} = E_{2t}}$$

موکلوهای میدان!

$$\oint D \cdot ds = \sum q = 0 \longrightarrow$$

چون باری روی سطح نیست

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = -\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

Subject: ۱۷

Year: Month: Date: ( )

یعنی زاویه ها متوالی قائم باشند ضرب دی الکتریک را ثابت دارد ←

$$\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\frac{E_{1t}}{E_{1n}}}{\frac{E_{2t}}{E_{2n}}} = \frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

خطوط از هم باز می شوند

شکل های زیر را بررسی می کنیم ←

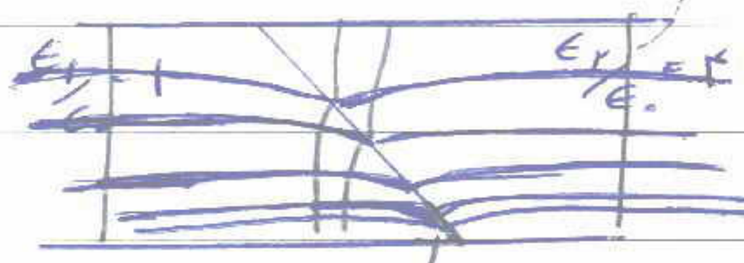
مثال:

این حالت بهتر است چون می دانیم بر یکدیگر در اطراف سنسل

هادی عاملی بیشتر است پس در این حالت که خطوط هم تا- خطوط میدان

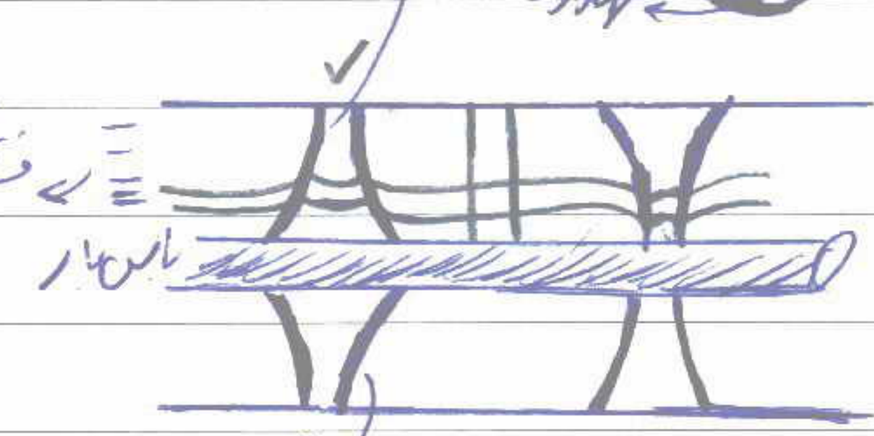
را طرف هادی کمتر هستند، شدت میدان هم

کمتر است



خطوط هم پتانسیل

نگهدارنده ها



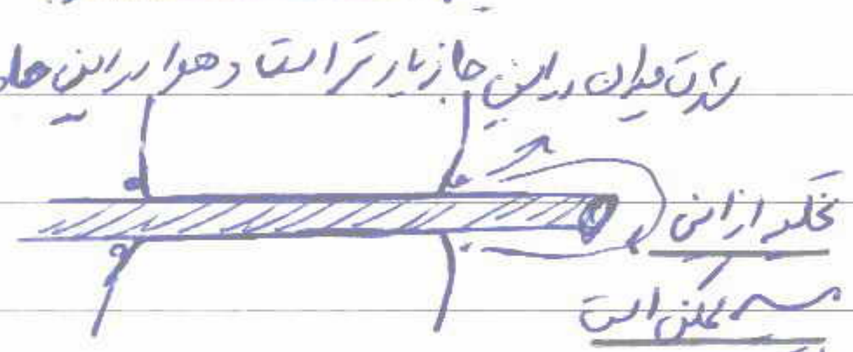
شدت میدان در این نقطه بیشترین مقدار را دارد

چون در راه دار، سطوح هم پتانسیل فشرده تر هستند خطوط میدان

فشردگی خطوط هم پتانسیل

نشده، تر خواهند شد ولی اگر بصورت یکنواخت پرش

می زدیم عایق کمتری لازم بود



شدت میدان در این جا بیشتر است و هوا در این جاها بیشتر خواهد شد

تخلیه از این

محل است

اتفاق میفتد

برای همین دو الکترود را طویل تر از عایق در نظر

می گیرند

نگهدارنده از نقطه بالا

- عایق را طوری پرش زده ایم که خطوط میدان سطح جدایی مانند در این حالت روی شدت میدان و خاصیت عایقی تأثیری نخواهد گذاشت.

سطح هم پتانسیل

عایق

نگهدارنده

میدان

لبه های کاتی هسته های هستند که باس بار شارژی در روی

لوله ای از گاز SF_6 پر شده است قرار دارد.

www.iran-ieee.com

Subject:

Year: Month: Date: ( )

استوانه‌های تودرتو مثل خازن‌های استوانه‌ای سری شده‌اند $A = 2\pi r l$ ، $C = \epsilon \frac{A}{d}$

کوتاه‌تر ← بلندتر

کوتاه‌تر طول هر آنتن این باشد ظرفیت (خازنی) لایه‌های بالایی بیشتر می‌شود ولی اگر طول هر لایه از لایه بالاتر اندکی کوتاه‌تر گرفته شود

ظرفیت این خازن‌ها با هم برابر شود خاصیت عایقی بالاتر خواهد شد که در سیم‌پیچ آنتن‌ها و هم جنس بودنشان

بوسینگ

سیم‌پیچ

هسته

عایق‌ها

از این نکته استفاده شده است و ولتاژ عایقی را مناسب‌تر کرده‌اند.

$2\pi r_1 l_1 = 2\pi r_2 l_2 = \dots$

لایه‌های بالاتر، طول کمتر آنتن

لیست‌های GIS:

سرفاز را

جای قرارداد روی سر رأس مثلث روی سر رأس یک سیم‌پیچ قرار می‌دهند.

آند

کاتد

سنر

ارتعاشات گیری‌ها

با این کار فاصله‌ی سرفاز مناسب خواهد بود

صد ۱۷ و ۱۸ هنرو امید

www.iran-ieee.com

Subject: ۱۸

Year: Month: Date: ( )

ارجاتی که ε_1 و ε_2 صفر نباشد یعنی ایده آل نباشند دیگر $\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$ نخواهد بود

عایق های گازی :

کلمه الکترونگاتیو : هوا عایق خوبی است.

اگر عایق جامد تحت الکتریکی صورت بگیرد پیر و خراب خواهد شد (پیر و خراب خواهد شد) ولی در عایق های گازی و مایع نه!

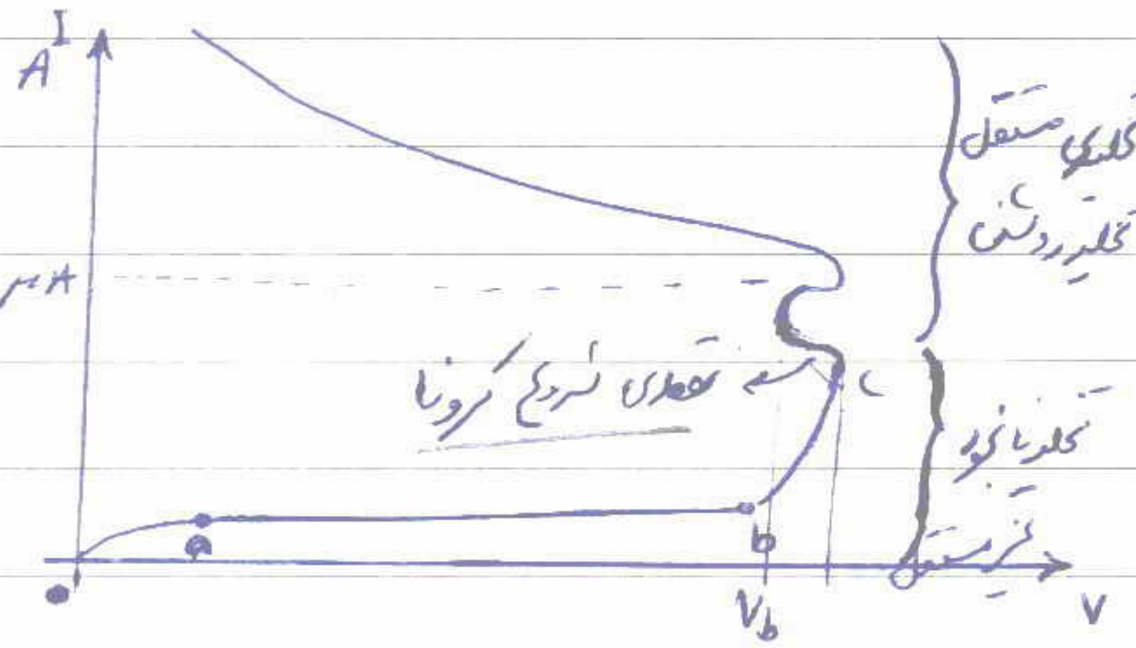
عامل هدایت در فلزات الکترون های آزاد هستند.

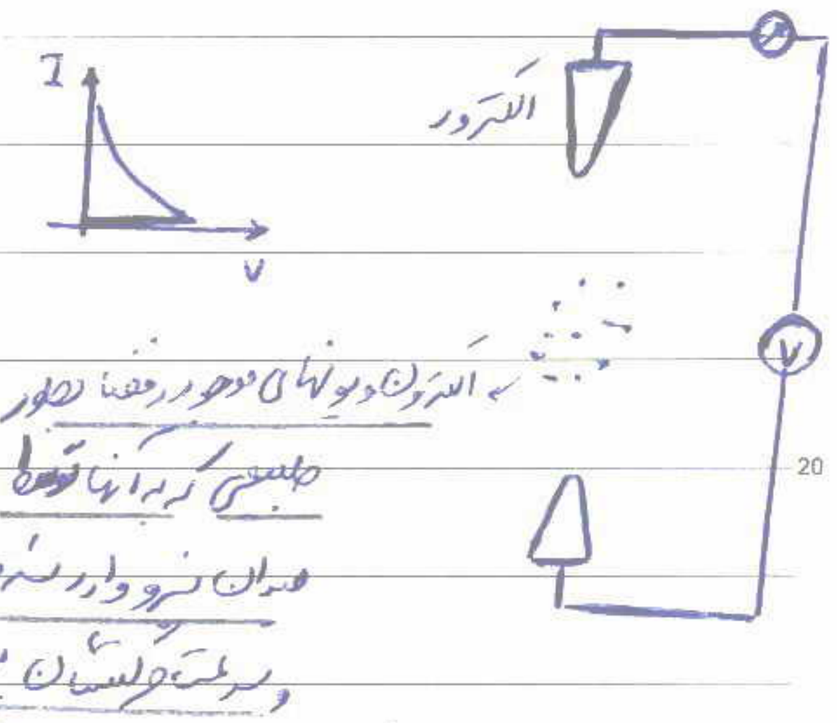
عامل هدایت در محلول ها یون های مثبت و منفی که تحت الکترون خود را از دست داده اند همچنین الکترون ها

عامل هدایت در گازها، الکترون ها و یون های آزاد شده

عایق خوب : ۱- هدایت الکتریکی آن کم باشد ۲- استقامت الکتریکی آن هم زیاد باشد (هر سه را)

خلاء هدایت الکتریکی کم هست اما استقامت الکتریکی آن بعد از هوا می شود و همین دلیل هوا از خلاء عایق بهتری است.





* هوا این خاصیت را دارد که از یک حدی به بعد هر چقدر ولتاژ را بیشتر کنی جریان بیشتر و از اینجا به بعد هر چقدر ولتاژ را بالا ببری تعداد یون و الکترون های آزاد ثابت خواهد بود و سرعت شان افزایش می یابد و به همین دلیل جریان ثابت می شود.

از ۱ تا ۴ : افزایش ولتاژ ← افزایش میدان ← افزایش نیرو ← افزایش سرعت الکترون ها و یون ها که بطور طبیعی در فضا وجود دارند

← یون ها و الکترون ها زمان کمتری برای ترکیب مجدد و خنثی شدن دارند ← افزایش جریان تا اینکه همه الکترون ها و یون های آن

PARSCO

www.iran-ieee.com

← ولتاژ شکست ـ حجم عایق تحت ولتاژ دارای بستگی دارد

در رطوبت بالا به این توجه داشته
Subject: که قطرات نیز آب سرگردان کار ایجاد
Year: - Month: Date: ( ) عایق خواهد بود.

ریز ارگانیزم ها آزاد می شوند و آلودگی ایجاد می کنند.

از a تا b: افزایش ولتاژ تأثیری بر افزایش جریان ندارد. کلیه ی الکترون ها و یون های آزاد شده به الکترودها می رسند ؟ ★

از b تا c: افزایش ولتاژ ← افزایش جریان ← افزایش سرعت تا حدی که بعضی از این یون ها انرژی شان در برخورد با ذرات دیگر قبل از رسیدن به الکترود خنثی می شود ← افزایش جریان

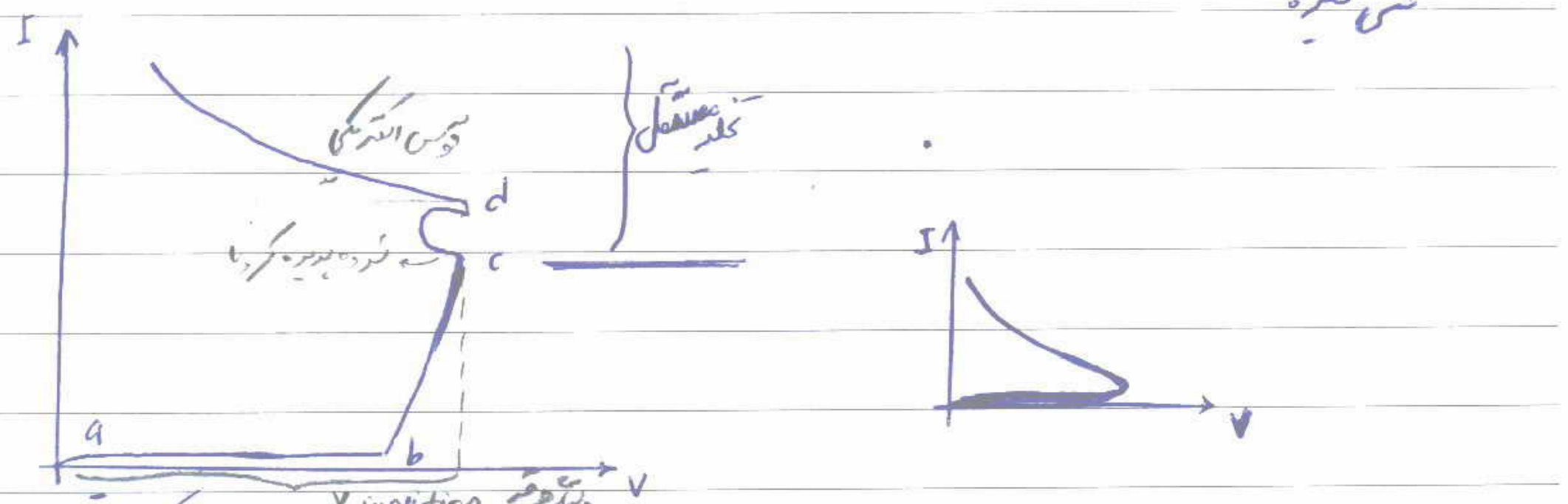
از c تا d را تخلیه ناخود یا غیر مستقل یا Non-self sustained Breakdown

از نقطه ی d به بعد یک افزایش کوچک ولتاژ باعث افزایش بی رویه جریان و ایجاد تخلیه ی درخشان یا تخلیه روشن

تخلیه مستقل: یعنی اگر الکترون آزادی هم در هوا نداشته باشد تخلیه صورت می گیرد.

این نوع تخلیه از جایی شروع می شود که سرعت الکترون های حرکتی می رسد که در برخورد با مولکول های دیگر هوا بتوانند الکترون آزاد کنند

شکل تخلیه:



★ علت نقل میزان حدود ۱۰ تا الکترون آزاد در ثانیه می توانند توکیه کنند که از بقیه ی کاتد دقیقاً بیشتر خواهد بود و تأثیری در مقدار جریان ندارد

چون تمام هر ۱۰ الکترون را می رساند به الکترود مثبت

PARSCO

ـ راه هایی از کابل های خارجی آسیب زیادی به آن ایجاد کرده اند که دوباره خواهد بود و سروصدا خواهد داشت و خرابی هایی زنند

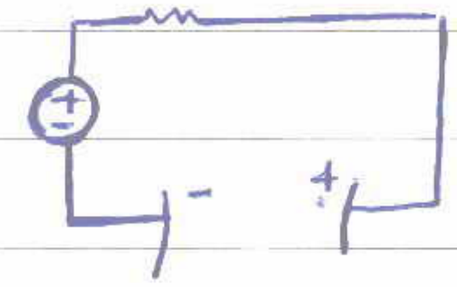
www.iran-ieee.com

Subject: ۱۹

Year: Month: Date: ( )

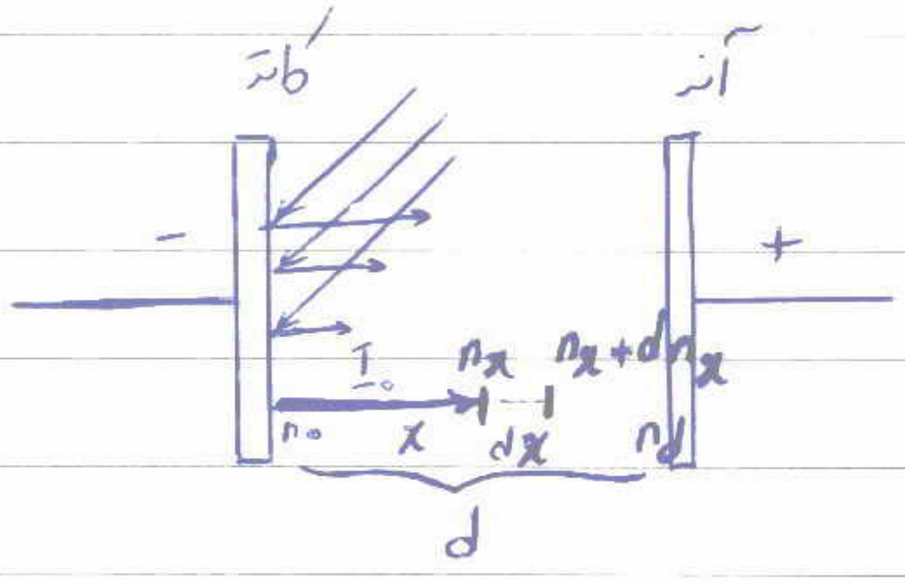
یک الکترون در مسیر حرکت الش آنقدر یون تولید میکند که

اگر منبع تغذیه مقاومت اهمی خیلی زیاد داشته باشد به طوری که انرژی خواهد گرفت بین دو برخورد کمتر از انرژی یونش نخواهد بود و انرژی آن



می افتد و لذا از دو الکترون کم می شود و جریان حاصل نمی شود.

پس برای اینکه بخواهیم توسط الکترون ها یونیزاسیون داشته باشیم باید مقاومت اهمی منبع کم باشد.



α تعداد برخوردهای یونیزه کننده به ازای حرکت یک الکترون

در طول یک سانتی متر مسیر

اگر یک الکترون یک سانتی متر حرکت کند می تواند: α

۲α: " " دو " " "

اگر دو الکترون یک سانتی متر حرکت کنند می تواند: ۲α

- α به E و P بستگی دارد.

E = فاصله متوسط آزاد

یعنی فاصله ای که یک الکترون بدون برخورد طی می کند

هرچه E ↑ افزایش یابد ← سرعت حرکت الکترون زیاد می شود ← بالطبع انرژی الکترون هنگام برخورد افزایش می یابد ← تعداد برخوردهای یونیزه کننده بیشتر می شود (α ↑)

و هم زیاد می شود

زمان حضور الکترون در فاصله بدون برخورد کم خواهد بود و فاصله بدون برخورد بیشتر خواهد بود

P احتمال زیاد یعنی تراکم ذرات زیاد باشد ← این عدد (P) بیشتر باشد ← تراکم ذرات بیشتر است ← فاصله متوسط آزاد که الکترون ها طی خواهد بود (۱/P) ↓

احتمال برخورد با آن رابطه مستقیم دارد ← احتمال برخورد بیشتر است

$$\alpha = P_x \left(\frac{E}{P}\right)$$

تأثیر پذیرفتن E و P عکس هم است.

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$\alpha = P \times f\left(\frac{E}{P}\right)$$

$$\frac{\alpha}{P} = f\left(\frac{E}{P}\right)$$

تعداد الکترون در فاصله x از کاتد : n_x

n_0 : " " " " صفر

تعداد برخوردهایی که یک الکترون طول یک میانگین طی می‌کند

$$dn_x = n_x \cdot \alpha \cdot dx \longrightarrow \int_{n_0}^{n_x} \frac{dn_x}{n_x} = \int_0^x \alpha\, dx \longrightarrow \ln\frac{n_x}{n_0} = \alpha x$$

$$\frac{n_x}{n_0} = e^{\alpha x} \leftarrow e^{\ln\frac{n_x}{n_0}} = e^{\alpha x}$$

$$n_x = n_0 e^{\alpha x}$$

$x = d$

$$n_d = n_0 e^{\alpha d}$$

تعداد الکترون‌هایی که از فاصله d آزاد می‌شوند

تعداد الکترون‌های ثانویه ایجاد شده

$$\frac{n_d - n_0}{n_0} = \frac{n_0 e^{\alpha d} - n_0}{n_0} = e^{\alpha d} - 1$$

یا تعداد الکترون‌های آزاد نسبی

تا قبل با توابین مواری

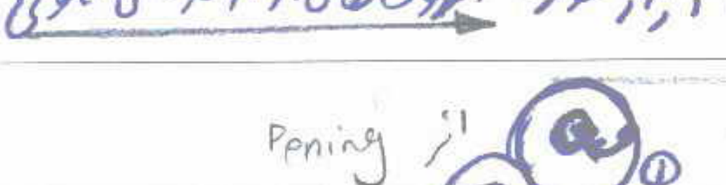
$$n_d = n_0 e^{\alpha d} \longrightarrow I_d = I_0 e^{\alpha d}$$

جریان ناشی از الکترون‌ها در $x=0$ هست I_0

و در $x=d$ هست I_d که I_d از I_0 بزرگتر است که این به این طریق ممکن است که یون‌های مثبتی که تولید می‌شوند به سمت کاتد حرکت کنند

$I_d > I_0$

که جمع جریان‌های این جریان‌ها صفر خواهد بود.



Secondary Process

پروسه ثانویه:

γ_1 (i) یون‌های مثبت ممکن است انرژی کافی برای آزاد کردن الکترون داشته باشند (یون‌های آزاد شده در مسیر حرکت هم ممکن است برخورد آزاد کننده داشته باشند)

γ_2 (ii) اتم‌های تحریک شده در اثر خنثی یونیزاسیون ممکن است الکترون آزاد کنند

γ_3 (iii) زوال ناپایدار ممکن است انرژی آزاد کند و باعث الکترون آزاد شود. الکترون‌های آزاد شده ثانویه

Penning از

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$$

$f(E,P)$

www.iran-ieee.com

Subject: ۲۰

Year: Month: Date: ( )

تعداد الکترون های آزاد شده در مرحله ثانوی آزاد ثانوی یا الکترون های

$n'' = n_0 + n_0'$

تعداد کل الکترون های ثانوی در کاتد: n''

$n = n'' e^{\alpha d} = (n_0 + n_0') e^{\alpha d}$ ①

تعداد کل الکترون های ثانوی که به آند می رسند.

$n - n''$ = تعداد الکترون های ثانوی که به آند می رسند $= n - (n_0 + n_0')$

تعداد آزاد شده در مرحله اولیه توسط یون های مثبت به سمت کاتد آند

برازش هر الکترون که آزاد شده از برخورد با یون های مثبت به کاتد برابر الکترون آزاد می شود در مرحله اولیه

$n_0' = \gamma [n - (n_0 + n_0')]$ ②

این جمله دوباره n_0' می دهد

از حذف n_0' بین ① و ②

$n = \frac{n_0 e^{\alpha d}}{1 - \gamma [e^{\alpha d} - 1]}$

را طوری تعیین کنند:

$1 - \gamma [e^{\alpha d} - 1] = 0$

$1 - \gamma (e^{\alpha d} - 1) \to 0$

$\gamma (e^{\alpha d} - 1) \geq 1$

شرط تخلیه تابنده:

به ازای هر الکترون که آزاد شده از برخورد با یون های مثبت به کاتد برابر الکترون آزاد می شود

$I = \frac{I_0 e^{\alpha d}}{1 - \gamma (e^{\alpha d} - 1)}$

آند ← $e^{\alpha d}$ الکترون می دهد ← کاتد ← الکترون

پس الکترون های آزاد شده $e^{\alpha d} - 1$ تا می شود

که هر الکترون آزاد شده γ تا الکترون ثانوی آزاد می کند

$\gamma (e^{\alpha d} - 1)$

ادامه صفحه:

جان این الکترون ها در مسیر حرکت شان تا آند با الکترون های ثانوی یا برخورد می کنند یکی از دو کار که این الکترون ها ممکن کاملا به آند برسند

که حالا این تعداد الکترون فعال کردیم یا الکترون ها که با عامل های خارجی برخورد می شود

که یا با عامل های خارجی

Subject:

Year: Month: Date: ( )

قانون پاشن:

ولتاژ شروع تخلیه تابعی از الکترود، فشار × فاصله الکترود است. pd

شرط تخلیه: تعداد الکترون های که در اثر یونش ایجاد می شوند باید حداقل یک الکترون باشند

$$\gamma\left[e^{\alpha d}-1\right] \geq 1$$

$$\gamma\left[e^{\alpha d}-1\right]=1 \quad (1)$$

چرا در رابطه α ، P نداریم؟ گاما

$$\frac{\alpha}{P}=f_1\left(\frac{E}{P}\right) \longrightarrow \alpha = P f_1\left(\frac{E}{P}\right) \quad (2)$$

چون γ خودش از α مشتق می شود $\gamma = f_2\left(\frac{E}{P}\right)$ (3)

وجود P در α کاهش یافته است

$E=\frac{V}{d}$

(1),(2),(3) $\longrightarrow f_2\left(\frac{E}{P}\right)\left[e^{Pd\, f_1\left(\frac{E}{P}\right)}-1\right]=1$

$$f_2\left(\frac{V}{Pd}\right)\left[e^{Pd\, f_1\left(\frac{V}{Pd}\right)}-1\right]=1$$

کامل

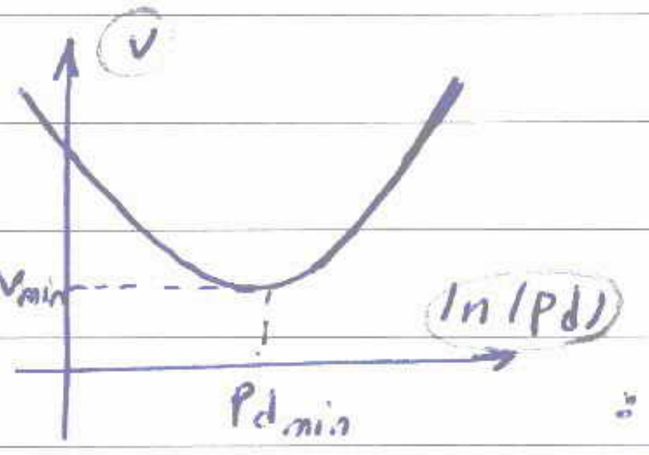
V ولتاژ شکست (ولتاژ شروع تخلیه)

رابطه‌ی بین V و pd

d فاصله‌ی بین دو الکترود

P فشار

$V = f(pd)$



تفسیر فیزیکی برای شرایط $Pd < Pd_{min}$:

یا P کوچک است ← فشار کم شده است ← تعداد مولکول ها کم می شود ← احتمال برخورد کم می شود

یا d کوچک است ← فاصله کم شده است ← مسیری که الکترون ها می پیمایند کم می شود ← احتمال برخورد کم می شود

پس ولتاژ شکست افزایش می یابد

تفسیر فیزیکی: $Pd > Pd_{min}$

یا P بزرگ است ← فشار زیاد شده است ← آنقدر فاصله‌ی مولکول ها کم می شود که الکترون ها برخوردهای یونش کافی برای یونیزاسیون ندارند یعنی قبل از این که سرعت کافی پیدا کنند برخورد می کنند

یا d بزرگ است ← فاصله زیاد شده است ← احتمال هدر رفت الکترون و یون ها در هوا زیاد می شود

PARSCO

www.iran-ieee.com

Subject: ۲۱

Year: Month: Date: ( )

$$V = ۲۴٫۲۲\,d + ۶٫۰۸\sqrt{d} \longrightarrow E = \frac{V}{d} = ۲۴٫۲۲ + \frac{۶٫۰۸}{\sqrt{d}}$$

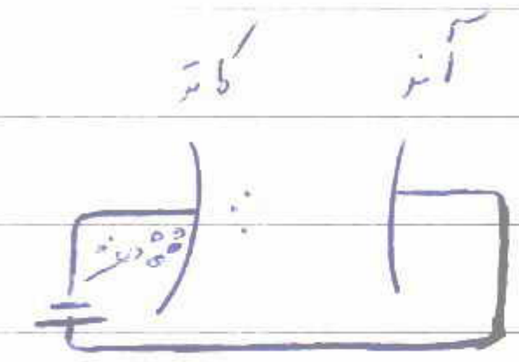
راهدان که برای هوا بدست آورده اند بصورت تجربی:

$$V = ۲۴٫۲۲\left[\frac{۲۹۳\,P\,d}{۷۶۰\,T}\right] + ۶٫۰۸\left[\frac{۲۹۳\,P\,d}{۷۶۰\,T}\right]^{\frac{1}{2}}$$

P: فشار برحسب mmHg — d: برحسب cm — T: دما برحسب کلوین — V: ولتاژ شکست هوا برای فاصله d برحسب kV

ولتاژ شکست هوا برای یک سانتی متر $۳۰\ KV/cm$ است.

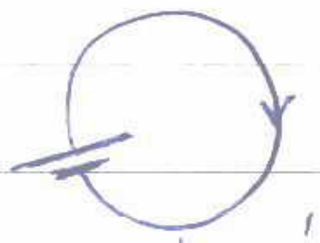
اگر کاتد گرم شود باعث می شود الکترون راحت تر از سطحش جدا شود.



$-۲۷۳\ ^\circ C$

الکترون ها از سطح کاتد آزاد می شوند البته اگر دمای کاتد از صفر مطلق بیشتر باشد تا این الکترون های آزاد

روی کاتد حرکت ایی داشته باشند که گرادیان خازنی آند الکترون ها را بسمت آند فرو نرود دوباره ممکن است خودهای کاتد باز گردند

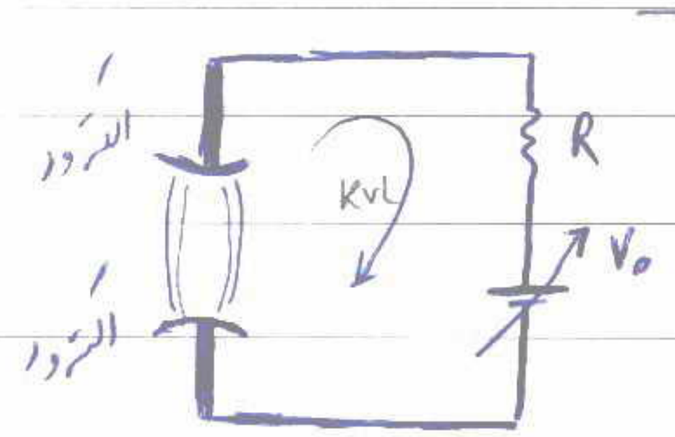


فرض کنید ذره ای در میدان مغناطیسی ای قرار می گیرد که این میدان نیروی

بر حسب خارج وارد می کند و حدود کل مدارها خیلی بزرگتر و باز شدن راه دور

جاهایی که نخواهند استقامت الکتریکی را از آن بگیرند

فشار را افزایش می دهند تا کاهش هزینه تجهیزات پست های GIS.

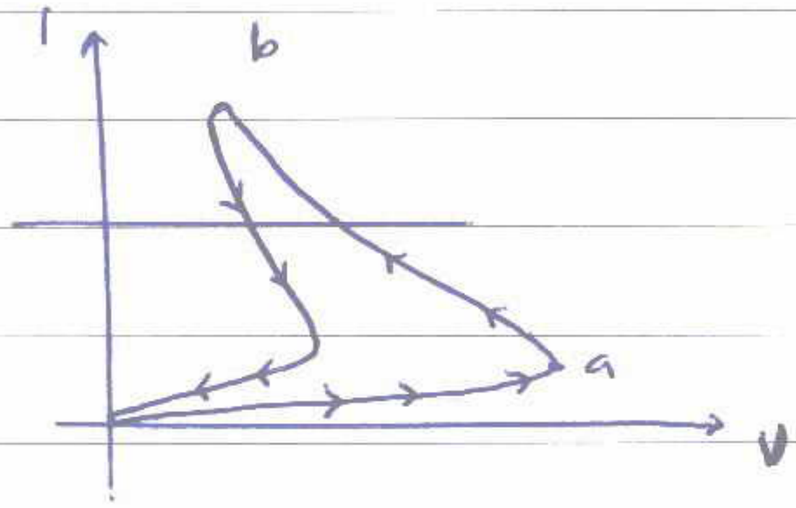


PARSCO

www.iran-ieee.com

شکست دینامیکی توسن:

اگر آرام دینامیک را کاهش دهیم روی همان مسیر رفت برگشت می‌کردیم ولی اگر سریع و نامنظم دینامیک را کاهش دهیم روی مسیر دیگری برمی‌گردیم



پدیده‌ای توان گفت در گذشت یون جسم گرم شده است

پدیده گذرا می‌باشد و نیاز است.

اثر Penning: ذرات آرگون و نئون

آرگون ← ضعیف‌ترین یونیزاسیون آن $15.7\ eV$ است.

نئون ← کوچکترین اتم پایدار نئون $16.7\ eV$ انرژی دارد.

$16.7\ eV$ انرژی آزاد می‌کند ← ضعیف‌ترین

انرژی یونیزاسیون کوچکترین اتم پایدار نئون

وقتی مقدار کمی نئون در آرگون بریزیم باعث آزاد شدن الکترون‌های آرگون خواهد شد.

استفاده از یکی از این دو از هر روی آنها بهتر است و نئون یا نئون هم برای شکست تفاوتی نیست.

www.iran-ieee.com

ادامه‌ی یون باعث می‌شود این نوک تیزکمی پخ‌تر شود یعنی به نظر باید و شدت میدان کمتر شود در این ناحیه

کرونا: ← یون‌ها

کرونای مثبت | + ⟵ الکترون‌ها رسوزی شکل مثبتی باشد و از این حالت شکست الکتریکی

دورتر از حالت کرونای مثبت رخ می‌دهد.

کرونای منفی | − ⟵ الکترون‌ها

بیشتر انتقالی‌های ثبت شده در حضور انتقال در این شکل گیت است به همین دلیل بالا می‌آید کرونای مثبت کرونا است

کرونای منفی: به صورت فرمان‌های پالسی Trichel Pulses می‌باشد و نور آن تقریباً متمایل به قرمز است.

کرونای مثبت: به صورت نور سفید رنگ یکنواخت دیده می‌شود

در کرونای AC: یک چیزی بین سفید و قرمز خواهد بود

مزایا و کاربردهای کرونا:

کاربردها: ۱- کابل‌ها که البته تعمیرات و نگهداری آن‌ها سخت خواهد بود مخصوصاً اگر در شیب استفاده شوند

۲- ترانس قدرت‌ها و توربین‌ها

۳- هیدهای رونی

مزایای رونی:

۱- عایقی ۲- خنک کردن ۳- خاموش کردن قوس الکتریکی در کلیدهای فشار قوی از طریق تزریق رونی و تولید گاز هیدروژن

معمولاً از نفت بدست می‌آیند؛ از هیدروکربن‌ها هم می‌توان رونی تولید کرد، از گیاهان هم می‌توان رونی تولید کرد.

در رنج حرارت‌های بالا از هیدروکربن‌ها استفاده می‌کنند.

- در رنج حرارت بالا از هیدروکربن‌ها رونی استفاده می‌کنند

رونی مایع کلیدین عمق حرارتی بالاتری دارد.

www.iran-ieee.com

ابتدا و انتها باید در حد جمع شدن باشد اختلاف پتانسیل قرار کاتد بیشتر خواهد شد و این ادامه خواهد
راست تا $J_2 = J_1 = J$ کل شود

Subject:

Year: Month: Date: ( )

حضور کمی ناخالصی مانند آب و... می‌تواند استحکام عایق را کاهش دهد.

خصوصیات مهم عایق مایع:

- هدایت الکتریکی باید کم باشد.

ناخالصی‌ها به شکل یون‌ها هم شدیداً استحکام الکتریکی را کاهش می‌دهند چون این یون‌ها حرکت می‌کنند

- ثابت دی الکتریک هرچی کمتر قطعاً با عایق بهتری هم نزدیک‌تر هم باشد.

- استحکام دی الکتریکی باید زیاد باشد.

- ویسکوزیته باید زیاد باشد (روانکاری) ولی در کابل‌ها باید کم باشد

- پایداری شیمیایی باید زیاد باشد. - خواص شیمیایی: پایداری شیمیایی، پایداری حرارتی، ویسکوزیته (مقاومت)

- پایداری حرارتی باید زیاد باشد.

- وزن مخصوص باید کم باشد. - عاری از ناخالصی باشد

- گرانی - کاربردهای متعدد

مخصوص دیالکتریک‌ها، پایداری شیمیایی است

- خصوصیات عایق مایع و حالت در مقابل عایق‌های گازی مقداری ناشناخته است چون در عایق گازی می‌توان فشار را تغییر

در آن خلیه‌ای ایجاد کرد ولی روی عایق جامد با انجام تخلیه از بین نخواهد رفت و عایق مایع هم در هر تخلیه ناخالصی‌های ایجاد شده از این

در عایق‌های مایع الکترون به‌وجود آمده است و خود مولکول‌های عایق اندک پویش می‌کنند اما بعد از یک سطح ولتاژ ناگهانی از مقداری می‌رود از سطح الکترود

الکترون گسیل می‌شود و جریان زیاد می‌شود

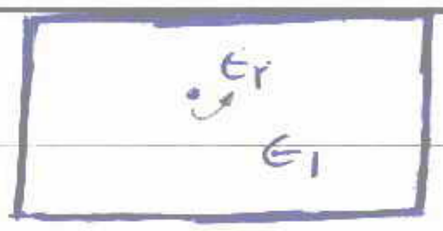
PARSCO
www.iran-ieee.com

Subject: ۲۳

Year: Month: Date: ( )

یکی از کشوری حجمی کربیان می شود

الف) کشوری روابط معلق روماسی:



چون ضریب ای الکتریک زره با مایع متفاوت است میدان در اطراف زره تغییر خواهد کرد، زره نیرو وارد خواهد شد.

روابط پراکندگی نوشته نمی شود بلکه شکل می گیرند و کد زیر را تشکیل می دهند

و ممکن که در این حالت رسانا اگر هوا تبدیل به مایع بیشتر باشد

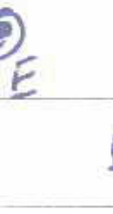
$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ باشد نیرو به سمت شدت میدان قوی تر است.

$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ باشد " " " ضعیف تر است.

ب) کشوری حجم های هوا و گاز

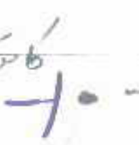
(توجه جزوه) $f \approx \nabla^3 \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + 2\varepsilon_1} E \operatorname{grad} E$

شدت میدان در اطراف زره زیاد خواهد شد و تخلیه الکتریکی رخ می دهد

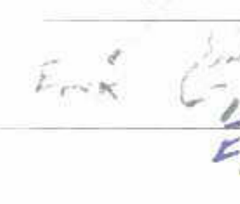


از سنجه دولتی هم تجزیه شده و گاز تولید می شود

ج) کشوری حجم مایع تک فاز الکتریکی



خیلی هم است که از جنبه رسانه مایع شدت میدان ماکزیمم وجود دارد



و جایی که حجم مایع که شدت میدان در آن زیاد است با شدت تخلیه زودتر صورت می گیرد.

- عبارت است از تقسیم مایع که شدت میدان در آن از ۰/۹ شدت میدان ماکزیمم بیشتر است

$0.9 E_{max}$ تا E_{max} : تعریف مایع تک فاز

و دلیل شکست بطور معمول میدان است با حجم مایع تک فاز الکتریکی حجم مایع تک فاز الکتریکی بیشتر است ↑ ، دلیل شکست ↓

- گرمایی که در اثر افزایش شدت جریان ایجاد شده است نیز نقش دارد.

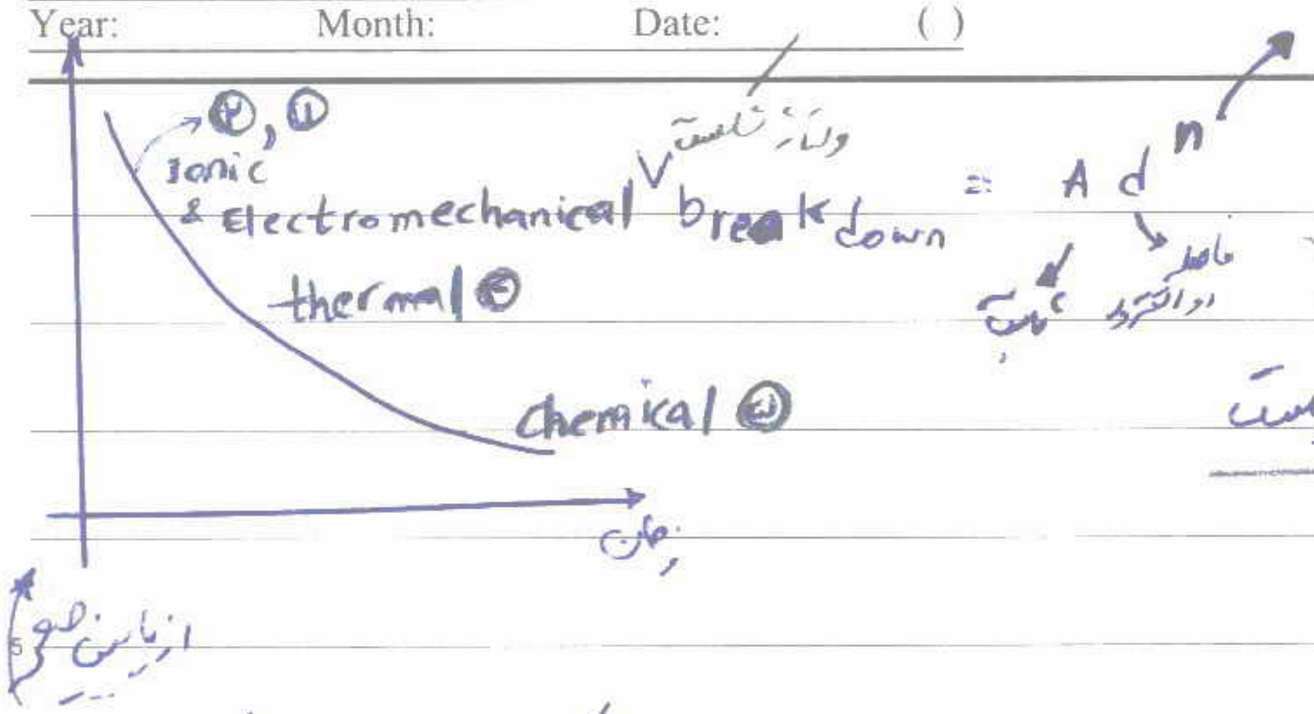
PARSCO

www.iran-ieee.com

www.iran-ieee.com

Subject:

Year: Month: Date: ( )



کوچکتر از ۱

$V = A\, d^{n}$

ثابت — فاصله دو الکترود

نکات مهم:

۱- رابطه ولتاژ شکست و فاصله‌ی دو الکترود خطی نیست

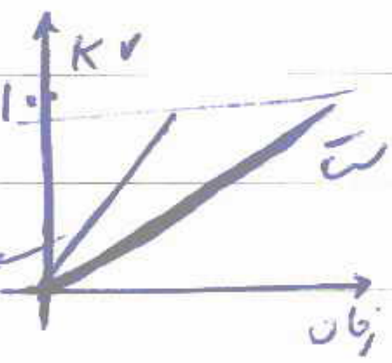
۲- ولتاژ شکست به شکل الکترود بستگی دارد.

۳- شکل فاز هم روی ولتاژ شکست تأثیر دارد.

ولتاژ شکست DC > ولتاژ شکست AC > ولتاژ شکست ضربه

چون بالا رفتن از صفر زمان نیاز دارد

۴- سرعت بالا رفتن ولتاژ بر شکست موثر است



- اگر سرعت افزایش ولتاژ به اندازه کافی زیاد نباشد ولتاژ کمتری رخ می دهد

۵- بهبود روش کاغذ دور سیم با فشار می شود استفاده عایق فایق زیادتر شود چون هوای مقدار زیادی از حباب‌های فشرده تبدیل

را می گیرد فشل شده شد. مثلاً: پل برقرار می شود چون فایق را استفاده

عایق های جامد:

اگر شکست الکتریکی از عایق جامد اتفاق بیافتد از بین خواهد رفت ول عایق مایع خودش و عایق گازی ۱۰۰ درصد به حالت

اولیه اش برمی گردد. عایق جامد خوب باید: ۱- استقامت مکانیکی مناسبی داشته باشد ۲- تلفات دی الکتریکی کم ۳- خالص بودن

۴- ولتاژ مخصوص کم ۵- مقاومت در برابر تأثیرات شیمیایی

۱- مکانیزم های شکست الکتریکی در عایق های جامد: Ionic یا intrinsic

ولتاژ شکست بالا هم نیست ولی هزینه اولیه کم دارد

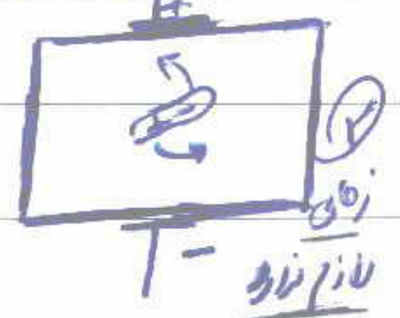
تبدیل می شود به کاهش یافته

۲- Electromechanical ۳- شکست ریلی ۴- Tracking & treeing شکست حرارتی ۵- شکست شیمیایی

در مورد کریستال ها و مولکول های تصفیه دارند

۶- شکست تخلیه جزئی داخلی - در حباب های هوا در آن باشد

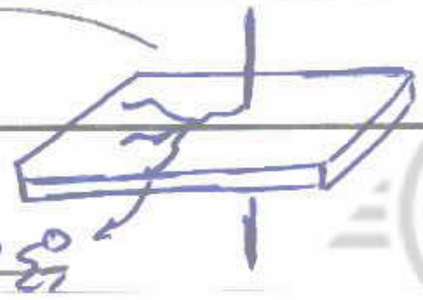
یا شکست از حباب های هوا شکل



این نمونه از هیچ عایق تمیز نشود و حتی برخی عایق

ندارد خلاف نمونه قبل

هیچ رطوبت هم نمی شود



www.iran-ieee.com